



CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **21 MARS 2003**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Mitteil

Martine PLANCHE

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

Seed^{LP} USA: 10/760/1631

address 701 Fifth Avenue,
Suite 6300
New York, NY 10017

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Anmeldung Nr:
Application no.: 03425180.1
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 21.03.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica 4
I-36100 Vicenza
ITALIE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Units for controlling the operating functions of a cycle, for instance for racing bicycles

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

B62M25/00

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT RO SE SI SK TR LI

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03425180.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

R C van Dijk

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Anmeldung Nr:
Application no.: 03425180.1
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 21.03.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica 4
I-36100 Vicenza
ITALIE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Units for controlling the operating functions of a cycle, for instance for racing bicycles

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

B62M25/00

Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT RO SE SI SK TR LI

**CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

"Unità per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo, ad esempio per biciclette da competizione"

Campo dell'invenzione

5 La presente invenzione si riferisce ai sistemi di controllo per cicli ed è stata sviluppata con particolare attenzione alle biciclette da competizione: il riferimento a questa possibile applicazione, ed in particolare all'applicazione nelle biciclette da corsa,
10 non deve però essere interpretato come limitativo del possibile campo di applicazione dell'invenzione.

Descrizione della tecnica nota

 Nel settore dei cicli si è sviluppata nel corso degli ultimi anni la tendenza a disporre di sistemi di
15 controllo elettronico cui sono delegate differenti funzioni. Tali sistemi di controllo elettronico sono pertanto atti a ricevere ed elaborare le informazioni raccolte da sensori di varia natura, per ricavare informazioni relative alle condizioni di
20 utilizzo/andamento del ciclo.

 Questi sistemi di controllo elettronico sono anche atti a permettere all'utilizzatore di comandare attuatori di varia natura per modificare, secondo determinati criteri e agendo in modo tanto automatico
25 quanto in funzione di specifici comandi impartiti dall'utilizzatore, le suddette condizioni di utilizzo/andamento del ciclo. In particolare, è noto controllare attraverso attuatori elettrici il cambio e il deragliatore di un ciclo.

30 Per la necessità di elaborare e fornire all'utilizzatore informazioni sulle condizioni di utilizzo/andamento del ciclo, tali sistemi di controllo sono provvisti di unità di visualizzazione.

 Queste unità di visualizzazione contengono un
35 processore con capacità di memoria, il cosiddetto

ciclocomputer, nel quale sono immagazzinate informazioni, che possono comprendere informazioni sensibili riguardo all'utilizzatore.

5 E', quindi, utile realizzare tali unità di visualizzazione amovibili, cioè in modo che possano essere separate dal sistema di controllo elettronico del ciclo.

Un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo siffatto è noto ad esempio
10 dalla domanda di brevetto italiano TO2000A000293 a nome della stessa Richiedente.

In tali sistemi di controllo noti, quando l'unità di visualizzazione è rimossa, tuttavia, le rimanenti unità componenti il sistema di controllo rimangono
15 fisse sul ciclo e, in particolare, i punti di connessione elettrica presenti su tali unità "fisse" per consentire la connessione rimovibile all'unità di visualizzazione rimangono scoperti e non protetti dall'acqua, dalla polvere, da urti o da manomissioni.

20 Tali elementi possono compromettere il funzionamento del sistema e contribuire alla scarica delle batterie delle unità. In più l'esposizione di tali contatti all'ambiente esterno può essere alla base di fenomeni di choc elettrostatico suscettibili di
25 compromettere il funzionamento di componenti sensibili quali microprocessori compresi nel sistema.

Scopi e sintesi dell'invenzione

La presente invenzione si prefigge lo scopo di evitare gli inconvenienti sopra delineati e di proporre
30 una soluzione che permetta di isolare i punti di connessione che rimangono scoperti in un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo di un ciclo quando è rimossa una parte amovibile.

Secondo la presente invenzione, tale scopo è
35 raggiunto grazie ad un sistema per controllare le

funzioni di utilizzazione di un ciclo comprendente almeno un'unità avente le caratteristiche richiamate in modo specifico nelle rivendicazioni che seguono.

5 In sostanza, la soluzione secondo l'invenzione prevede di dotare almeno una delle unità del sistema di elementi di interruzione della continuità elettrica, atti ad intervenire in presenza della rimozione di un'unità del sistema.

Breve descrizione dei disegni annessi

10 L'invenzione sarà ora descritta, a puro titolo di esempio non limitativo, con riferimento ai disegni annessi, nei quali:

- la figura 1 rappresenta uno schema di principio di un sistema per controllare le funzioni di
15 utilizzazione di un ciclo secondo l'invenzione in una prima configurazione di funzionamento;
- la figura 2 rappresenta uno schema di principio parziale di un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo secondo l'invenzione in
20 una seconda configurazione di funzionamento, e
- le figure 3 e 4 rappresentano, secondo modalità sostanzialmente analoghe a quelle adottate nelle figure 1 e 2, una variante realizzativa della soluzione qui descritta.

25 Descrizione particolareggiata di esempi di attuazione dell'invenzione

In figura 1 è mostrato lo schema a blocchi parziale di un sistema 2 per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo (non illustrato nei disegni).

30 In termini generali, un tale sistema è descritto nel documento TO2000A000293 (già citato in precedenza e qui incorporato tramite citazione), il che rende superfluo fornire una descrizione particolareggiata in questa sede.

Per quanto qui interessa, sarà sufficiente ricordare che il sistema 2 comprende un'unità di visualizzazione 21, un'unità comandi 22 e un'unità di potenza 23.

5 Di queste, l'unità comandi 22 e l'unità di potenza 23 sono montate sul ciclo in condizione di montaggio stabile, ossia in posizione "fissa". L'unità di visualizzazione 21 è invece configurata in modo da essere selettivamente amovibile dal ciclo.

10 L'unità di potenza 23 provvede alla gestione delle richieste di posizionamento per il cambio e per il deragliatore, controllando il funzionamento di un attuatore del cambio 14 e un attuatore del deragliatore 15, i quali sono associati a rispettivi trasduttori di
15 posizione 16 e 17.

Tali trasduttori di posizione 16 e 17 forniscono l'informazione sulla posizione del cambio e del deragliatore all'unità di potenza 13 in modo da permettere un ottimale controllo degli attuatori 14 e
20 15 e l'esecuzione di procedure quali l'azzeramento della posizione degli attuatori e la compensazione di derive o scarti della posizione.

L'unità di potenza 23 alimenta l'unità comandi 22 tramite una connessione 102 facente capo ad un bus di
25 alimentazione 103 con associato un bus di comunicazione 104.

Inoltre, una connessione 105 estende i bus 103 e 104 verso l'unità di visualizzazione 21.

La connessione 105 è di tipo disaccoppiabile, ossia
30 sconnettibile, per consentire di rimuovere l'unità di visualizzazione 21, separandola dal resto del sistema.

La connessione 105 è realizzata tramite un apposito connettore maschio-femmina a quattro conduttori, oppure tramite contatti a strisciamento, così da presentare
35 contatti 107 sull'unità comandi 22 e corrispondenti

contatti 108 sull'unità di visualizzazione 21. Tali contatti sono rappresentati in modo schematico nelle sole figure 2 e 4.

5 Connesso in parallelo sul bus di comunicazione 104 nell'unità comandi 22 è disposto un microcontrollore 27, provvisto di ingressi 28 e 29 per ricevere rispettivi comandi relativi al cambio e al deragliatore. Il microprocessore 27 provvede quindi a inoltrare detti comandi sul bus di comunicazione 104
10 all'unità di potenza 23. L'unità comandi 22 comprende un circuito ausiliario di alimentazione 30 che monitora in modo noto il funzionamento di una batteria ausiliaria 34 per il microcontrollore 27.

15 L'unità di visualizzazione 21 comprende un display 24, pilotato da un microprocessore 25. Il microprocessore 25 è atto a eseguire le funzioni di ciclocomputer e a comunicare tramite il bus di comunicazione 104 con l'unità comandi 22.

20 Un circuito ausiliario di alimentazione 26 monitora in modo noto il funzionamento di una batteria ausiliaria 33 per il microcontrollore 25.

25 L'unità di visualizzazione 21 comprende inoltre un magnete 31, collocato in prossimità della connessione 105, mentre tre interruttori magnetici 32, di tipo reed switch, dunque suscettibili di essere attivati in chiusura dal magnete 31, sono disposti sul bus di comunicazione 104 e su uno dei conduttori del bus di alimentazione 103.

30 Quindi, quando l'unità di visualizzazione 21 è montata sul ciclo, il magnete 31 mantiene chiusi gli interruttori magnetici 32.

Qualora l'unità di visualizzazione 21 sia rimossa, il magnete 31 montato su di essa si allontana dagli interruttori magnetici 32. Tali interruttori magnetici
35 32 si aprono, isolando elettricamente l'unità comandi

22 rispetto alle estremità distali 107 delle linee previste per il collegamento all'unità di visualizzazione 21 di collegamento.

Di conseguenza, l'eventuale esposizione di tali
5 estremità distali 107 all'ambiente esterno ed agli agenti esterni non è in grado di avere influenze di sorta sull'unità comandi 22 (e sull'unità di potenza 23) in quanto le suddette estremità distali 107 sono fisicamente separate ed isolate rispetto alle unità 22
10 e 23 montate sul ciclo.

Questo fatto è ancor meglio apprezzabile osservando la figura 2, che si riferisce alla situazione in cui l'unità di visualizzazione 21 è stata rimossa e spostata rispetto all'unità comandi 22 di una distanza
15 tale per cui il magnete 31 non esercita più la sua forza sugli interruttori magnetici 32, che sono in posizione di apertura.

In particolare, anche se i contatti 107 rimangono scoperti ed esposti, i relativi conduttori appartenenti
20 al bus di alimentazione 103 e al bus di comunicazione 104 non possono, ed esempio, essere cortocircuitati da umidità condensata al disopra dei contatti 107. Tali contatti 107 sono infatti fisicamente separati ed isolati rispetto ai suddetti conduttori del bus di
25 comunicazione 104 e del bus di alimentazione 103.

Si evita così che attraverso la connessione 105 possano avvenire fenomeni di scarica delle batterie.

Analogamente, si evita che attraverso la
connessione 105 possano avvenire fenomeni di
30 trasferimento di carica elettrostatica verso i bus 103 e 104 ed i dispositivi su di essi attestati.

Nelle figure 1 e 2 sono mostrati tre interruttori ad ampolla reed, un tale interruttore non essendo previsto sul quarto conduttore.

Nell'esempio illustrato, tale conduttore è infatti il conduttore di terra del bus di alimentazione 103, difficilmente suscettibile di dare origine ai fenomeni negativi citati in precedenza, anche perché i tre
5 interruttori reed impediscono comunque lo stabilirsi di una linea di ritorno.

E' però chiaro che ambedue i conduttori del bus di alimentazione 103 possono essere muniti di interruttori quali gli interruttori 32.

10 La variante realizzativa illustrata nelle figure 3 e 4 (corrispondenti rispettivamente alle figure 1 e 2) adotta in termini generali lo stesso schema circuitale già descritto in precedenza. Per questo motivo, per
15 indicare parti ed elementi identici od equivalenti a quelli già descritti, nelle figure 3 e 4 sono stati adottati gli stessi riferimenti che già compaiono nelle figure 1 e 2.

La variante realizzativa illustrata nelle figure 3 e 4 prevede di estendere anche ai contatti (estremità
20 distali) 108 della connessione 105 che si trovano sull'unità di visualizzazione 21 lo stesso meccanismo di protezione descritto in precedenza con riferimento ai contatti 107 che si trovano sull'unità di comandi 22.

25 Anche in questo caso, il meccanismo di protezione - basato sull'isolamento fisico dei contatti 108 rispetto all'unità 21 ed ai componenti che si trovano al suo interno - prevede al presenza di una pluralità di interruttori 35.

30 Questa volta gli interruttori (sempre costituiti di preferenza da ampolle reed) sono però collocati collocati sull'unità di visualizzazione 21 così da essere azionabili da un magnete 36 disposto sull'unità comandi 22.

Quindi, quando l'unità di visualizzazione 21 è montata sul ciclo, le due unità 21 e 22 sono vicine fra loro e, così come il magnete 31 mantiene chiusi gli interruttori 32, il magnete 36 mantiene chiusi gli
5 interruttori 35. La connessione 105 presenta quindi carattere di continuità elettrica, svolgendo appieno la sua funzione.

Di converso, quando l'unità di visualizzazione 21 è rimossa dal ciclo, le due unità 21 e 22 sono
10 allontanate. Il magnete 31 non è più in grado di mantenere chiusi gli interruttori 32 ed il magnete 36 non è più in grado di mantenere chiusi gli interruttori 35.

Gli interruttori 32 e 35 si aprono ed i contatti
15 107 e 108, rimasti esposti per effetto della rimozione dell'unità di visualizzazione 21 e dell'interruzione della connessione 105, sono così fisicamente isolati dalle rispettive unità.

Per quanto riguarda la scelta del numero e della
20 collocazione degli interruttori 35 valgono essenzialmente le stesse considerazioni fatte riguardo agli interruttori 32.

Naturalmente, così come schematicamente illustrato nelle figure 3 e 4, le posizioni di montaggio dei
25 magneti 31 e 36 sono scelte in modo che i magneti non si influenzino a vicenda e, in particolare, in modo da evitare che il magnete 36 mantenga stabilmente chiusi i contatti 32 e/o il magnete 31 mantenga stabilmente chiusi i contatti 35.

30 La soluzione appena descritta consente di conseguire notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni note.

Il sistema per controllare le funzioni di
35 utilizzazione di un ciclo proposto vantaggiosamente permette di ottenere un isolamento automatico dei punti

di connessione sull'unità comandi e/o sull'unità di visualizzazione, attraverso un'interruzione della continuità fisica dei segnali da e verso l'esterno di dette unità.

5 Vantaggiosamente, l'isolamento ottenuto tramite il sistema secondo l'invenzione non impedisce all'unità comandi e all'unità di potenza di funzionare autonomamente.

10 L'impiego di interruttori magnetici in forma di ampolle reed switch è particolarmente vantaggioso su un ciclo, dato che esso è esposto a forti vibrazioni. Inoltre il magnete sull'unità di visualizzazione e/o sull'unità di comandi è un dispositivo economico che non richiede alcun tipo di alimentazione.

15 Tuttavia è chiaro che le ampolle reed switch possono essere sostituite da altri dispositivi magnetici o elettromeccanici equivalenti, quali altri tipi di relè a equipaggio mobile o a sensore di Hall, oppure da interruttori, in particolare interruttori
20 controllati tramite altro tipo di segnale, quale un segnale ottico o a radiofrequenza, o altri tipi di sensori o dispositivi di prossimità atti a indurre la commutazione di un interruttore remotamente collocato.

 Sarà infatti apprezzato che gli interruttori
25 magnetici disposti sull'unità comandi 22 e/o di visualizzazione 21 e il magnete disposto sull'unità di visualizzazione 21 e/o comandi 22 realizzano un dispositivo di commutazione a prossimità che è attivato in commutazione quando l'unità di visualizzazione 21 è
30 rimossa ovvero montata sul ciclo. Un tale dispositivo può essere realizzato in modo funzionalmente equivalente in molte forme diverse.

 A titolo di esempio (e senza voler in alcun modo esaurire il campo delle possibilità) si possono citare
35 le seguenti soluzioni:

- commutatori di prossimità di tipo meccanico (proximity switch),
- commutatori di prossimità allo stato solido quali coppie fotoemettitore-fotorivelatore,
- 5 - commutatori ottici quali fotocellule o fotorivelatori in genere, suscettibili di essere esposti o oscurati a seconda che l'unità di visualizzazione 21 sia rimossa ovvero montata sul ciclo,
- 10 - sensori di prossimità a campo elettromagnetico o ad ultrasuoni.

Il sistema di controllo può prevedere che l'unità comandi 22 rilevi l'apertura degli interruttori dovuta alla rimozione dell'unità di visualizzazione 21 e
15 intervenga per inibire in tali condizioni il funzionamento del sistema stesso. In alternativa l'unità comandi 22 può essere configurata per rilevare l'apertura degli interruttori magnetici e implementare un insieme di funzioni di locomozione di base, quali la
20 cambiata e la deragliata, garantendone lo svolgimento in condizioni di rimozione dell'unità di visualizzazione dal ciclo.

Da quanto sopra esposto consegue che, fermo restando il principio dell'invenzione, i particolari di
25 realizzazione e le forme di attuazione potranno essere ampiamente variati rispetto a quanto descritto ed illustrato, senza per questo uscire dall'ambito della presente invenzione, così come definita dalle rivendicazioni annesse.

RIVENDICAZIONI

1. Unità (22, 21) di un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo, destinata a cooperare funzionalmente con almeno un'unità complementare (21, 22) per mezzo di almeno una
5 connessione elettrica (105); almeno una (21, 22) fra detta unità (22, 21) e detta unità complementare (21, 22) essendo configurata per essere selettivamente rimovibile dal ciclo, per cui detta almeno una
10 connessione elettrica (105) è una connessione elettrica disaccoppiabile lasciando su detta unità (22, 21) almeno una parte distale di contatto (107, 108) esposta, caratterizzata dal fatto che a detta almeno una connessione elettrica (105) è associato almeno un
15 interruttore (32, 35) selettivamente azionabile per isolare elettricamente da detta unità (22, 21) detta parte distale di contatto (107, 108) esposta.

2. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detto interruttore (32,
20 35) è azionabile in funzione della prossimità di detta unità complementare (21, 22) a detta unità (22, 21).

3. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 1 o la rivendicazione 2, caratterizzata dal fatto che detto interruttore (32, 35) collega elettricamente detta
25 unità (22, 21) a detta parte distale di contatto (107, 108) quando detta unità (22, 21) e detta unità complementare (21, 22) sono in condizioni di vicinanza fra loro.

4. Unità (22, 21) secondo una qualsiasi delle
30 precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto che detta connessione elettrica (105) è una connessione elettrica multifilare disaccoppiabile lasciando su detta unità (22, 21) una pluralità di parti distali di contatto (107, 108) esposte e dal fatto che a detta
35 connessione elettrica è associata una pluralità di

interruttori (32, 35) selettivamente azionabili per effetto dell'allontanamento di detta unità (22, 21) e di detta almeno un'unità complementare (21, 22) per isolare elettricamente da detta unità (22, 21) dette
5 parti distali di contatto (107, 108) esposte.

5. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 4, caratterizzata dal fatto che una linea di detta connessione elettrica (105) multifilare si estende con continuità verso la rispettiva parte distale in assenza
10 di un detto interruttore (32, 35).

6. Unità (22, 21) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta connessione elettrica (105) è inserita in almeno un bus (103, 104)

15 7. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 5 e la rivendicazione 6, caratterizzata dal fatto che detta linea estendentesi con continuità è una linea di terra di detto almeno un bus.

20 8. Unità (22, 21) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto che detto interruttore (32, 35) è un interruttore reed azionabile da un magnete (31, 36).

25 9. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 1 o la rivendicazione 8, caratterizzata dal fatto che detto interruttore (32, 35) è montato in posizione tale che, con detta unità (22, 21) e detta unità complementare (21, 22) cooperanti fra loro, esso risulta esposto a detta unità complementare (21, 22) così da risultare azionabile da un elemento di azionamento (31, 36) posto
30 su detta unità complementare (21, 22).

10. Unità (22, 21) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, caratterizzata dal fatto di essere configurata per il montaggio stabile su detto ciclo.

11. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di comprendere almeno un elemento di azionamento (36, 31) per azionare almeno un interruttore (35, 32) presente in detta unità
5 complementare (21, 22

12. Unità (22, 21) secondo la rivendicazione 11, caratterizzata dal fatto che detto elemento di azionamento (36, 31) è posizionato in modo tale da essere ininterferente con un elemento di azionamento
10 omologo (31, 36) presente in detta unità complementare (22, 21).

13. Unità complementare (21, 22) di un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo, destinata a cooperare con almeno una unità (22, 21)
15 secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 12, caratterizzata dal fatto di comprendere almeno un elemento di azionamento (31, 36) per detto interruttore (32, 35).

14. Unità complementare (21, 22) secondo la
20 rivendicazione 13, caratterizzata dal fatto che detto elemento di azionamento (31, 36) è un magnete.

15. Unità complementare (21, 22) secondo la rivendicazione 13 o la rivendicazione 14, caratterizzata dal fatto di essere configurata per
25 essere selettivamente rimovibile da detto ciclo.

16. Unità complementare (21, 22) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 13 a 15, caratterizzata dal fatto di essere configurata come unità di visualizzazione (21).

30 17. Unità complementare (21, 22) secondo la rivendicazione 13, caratterizzata dal fatto di comprendere almeno un interruttore (35, 32) selettivamente azionabile per isolare elettricamente da detta unità (21, 22) detta parte distale di contatto
35 (108, 107) esposta.

RIASSUNTO

Un'unità (22) di un sistema per controllare le funzioni di utilizzazione di un ciclo è suscettibile di cooperare funzionalmente con almeno un'unità complementare (21) a mezzo di almeno una connessione elettrica (105). Almeno una (21) fra tale unità (22) e l'unità complementare (21) è configurata per essere selettivamente rimovibile dal ciclo, per cui la connessione elettrica (105) è una connessione elettrica disaccoppiabile lasciando sull'unità (22) almeno una parte distale di contatto (107) esposta. A tale almeno una connessione elettrica è associato un interruttore (32) selettivamente azionabile per isolare elettricamente da detta unità (22) detta parte distale di contatto (107) esposta.

(Figura 1).

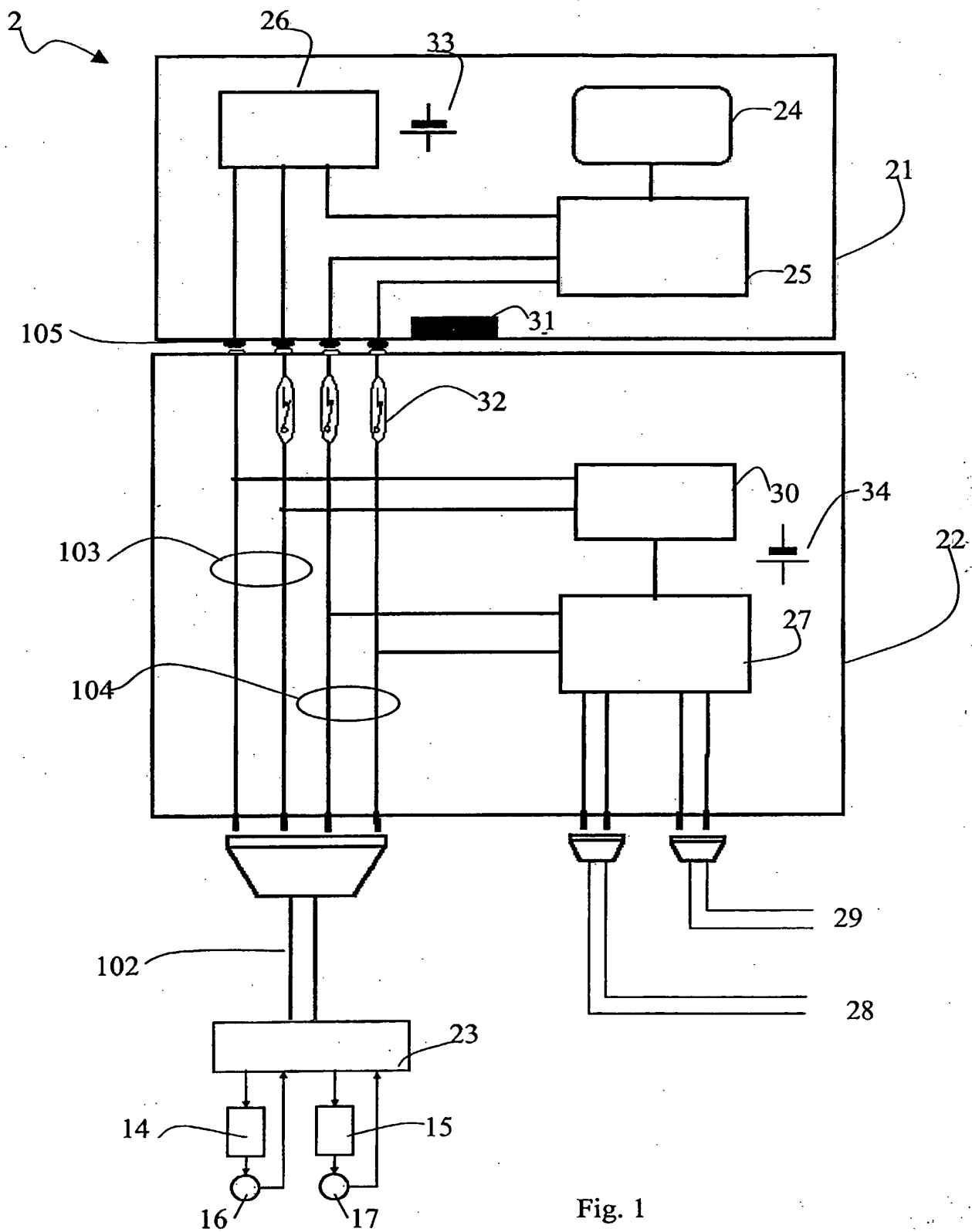


Fig. 1

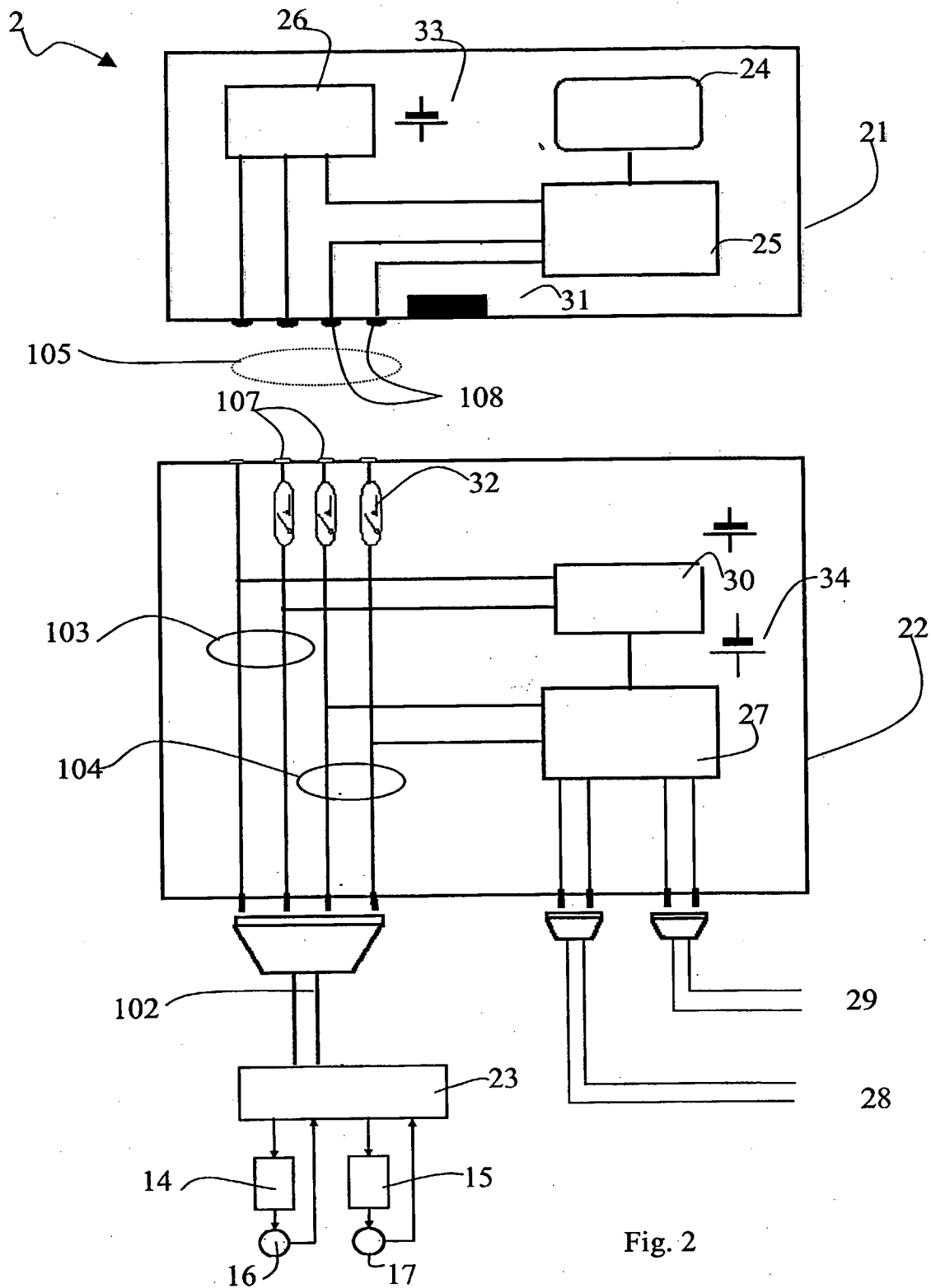


Fig. 2

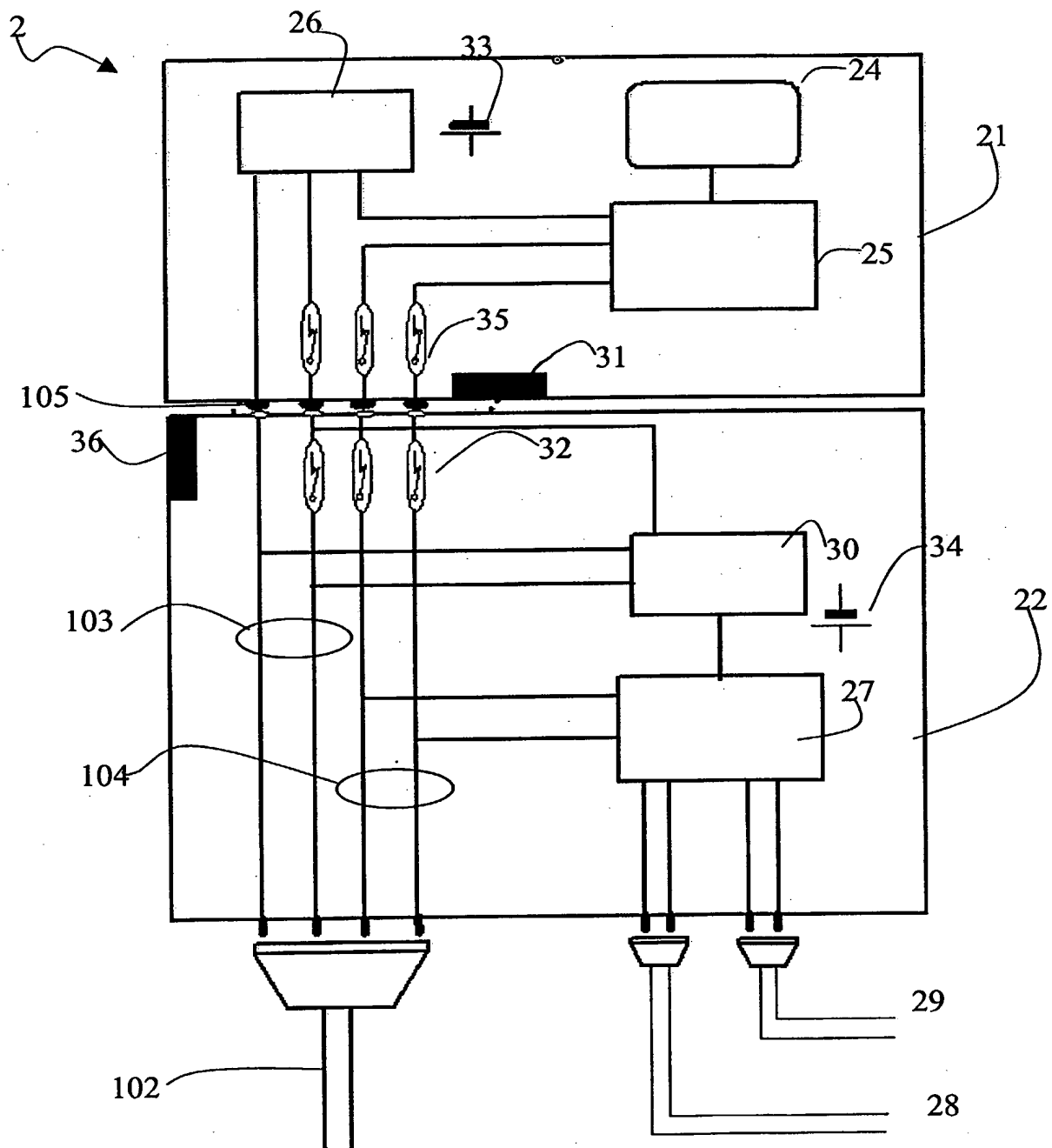


Fig. 3

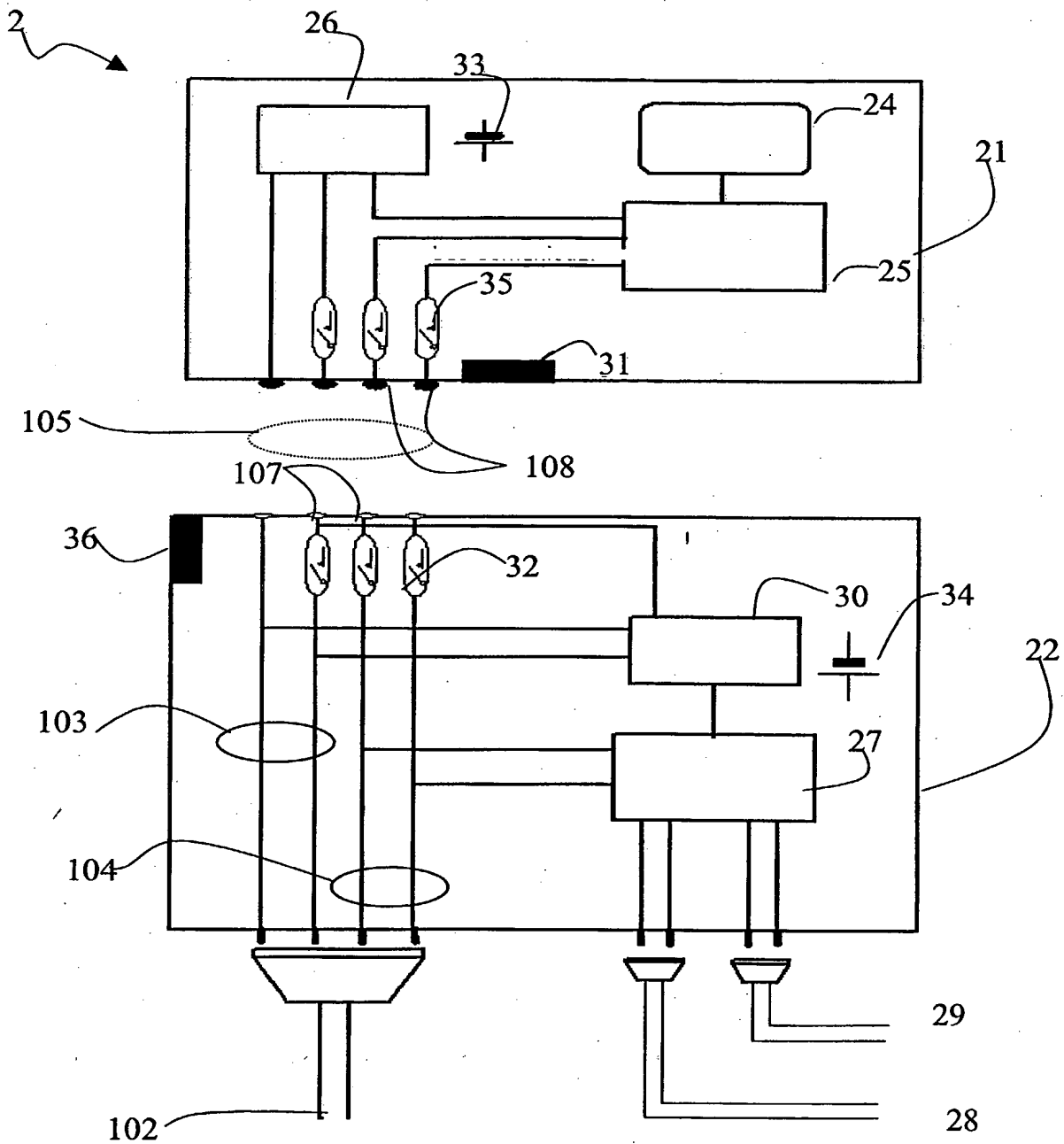


Fig. 4



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • W / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 21 JAN 2003 LIEU 13 INPI MARSEILLE N° D'ENREGISTREMENT 0300615 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 21 JAN. 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE OMNIPAT MARCHAND André 24 Place des Martyrs de la Résistance 13100 AIX EN PROVENCE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 100212 FR			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Décodeur de ligne de mot à tension négative, ayant des éléments de terminaison de faible encombrement			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		STMICROELECTRONICS SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		3 4 1 4 5 9 3 8 6	
Code APE-NAF		3 2 1 B	
Domicile ou siège	Rue	29 Boulevard Romain Rolland	
	Code postal et ville	9 2 1 2 0 MONTROUGE	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE 21 JAN 2003 LIEU 13 INPI MARSEILLE N° D'ENREGISTREMENT 0300615 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 210502
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom		MARCHAND	
Prénom		André	
Cabinet ou Société		OMNIPAT	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	24 Place des Martyrs de la Résistance	
	Code postal et ville	13 100 AIX EN PROVENCE	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		04.42.99.06.60	
N° de télécopie (facultatif)		04.42.99.06.69	
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [] [] [] [] []	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint <input type="checkbox"/> La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe <input type="checkbox"/>			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) MARCHAND André - CPI N° 95 0303 OMNIPAT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

DECODEUR DE LIGNE DE MOT A TENSION NEGATIVE, AYANT DES
ELEMENTS DE TERMINAISON DE FAIBLE ENCOMBREMENT

La présente invention concerne un décodeur de ligne de mot à tension négative sélective, notamment pour mémoire Flash.

La présente invention vise plus particulièrement un
5 perfectionnement d'un décodeur du type décrit dans la
demande WO 02/41322 (figures 5 et 6), permettant
d'appliquer sélectivement à des lignes de mot d'un plan
mémoire des tensions d'effacement négatives, et de
réaliser ainsi les mémoires Flash effaçables par page,
10 une page représentant une ligne de mot.

La figure 1 représente très schématiquement un plan
mémoire Flash MA et un décodeur de ligne de mot WLDEC1 du
type décrit dans la demande susmentionnée. Le plan
mémoire MA comprend des transistors à grille flottante
15 FGT agencés en lignes et en colonnes, formant chacun une
cellule mémoire rémanente. Les transistors FGT ont leurs
grilles de commande reliées à des lignes de mot WLi et
leurs sources ou leurs drains reliés à des lignes de bit
BLk.

20 Le décodeur WLDEC1 comprend un prédécodeur PREDEC
et un postdécodeur POSTDEC alimentés par une tension Vcc,
fournissant des signaux de sélection de lignes de mot
SELi. Lorsqu'une adresse déterminée ADR est fournie au
décodeur, le signal de sélection SELi de la ligne de mot
25 WLi désignée par cette adresse est mis à 1 (tension Vcc)
tandis que tous les autres signaux de sélection sont à 0
(masse). Les signaux SELi sont appliqués à des circuits

adaptateurs de tension ADi délivrant chacun une tension V_i à une ligne de mot WLi . Chaque adaptateur de tension ADi reçoit également un signal ERASE, une tension VPOS et une tension VNEG. La tension V_i peut être
5 positive, négative ou nulle selon l'opération en cours d'exécution, la valeur du signal de sélection $SELi$ et la valeur des tensions VPOS, VNEG.

Comme cela est décrit par le tableau 1 ci-après, le signal ERASE est à 1 dans le mode effacement et à 0 dans
10 les autres modes de fonctionnement de la mémoire. La tension VPOS est égale à une tension de lecture VREAD dans le mode lecture, à une tension de programmation VPP dans le mode programmation et à une tension d'inhibition d'effacement VEINHIB dans le mode effacement. La
15 tension VNEG est égale à une tension de non-lecture VNREAD dans le mode lecture, à une tension d'inhibition de programmation VPINHIB dans le mode programmation et à une tension d'effacement négative VER dans le mode effacement.

20 La figure 2 représente l'architecture d'un adaptateur de tension ADi. L'adaptateur ADi comprend une porte G1 de type OU EXCLUSIF recevant en entrée les signaux $SELi$ et ERASE et délivrant un signal COM. Le signal COM est appliqué à une porte inverseuse G2
25 délivrant un signal NCOM. Les portes G1, G2 sont alimentées par la tension VPOS et les signaux COM, NCOM sont portés à la tension VPOS lorsqu'ils sont à 1. Les signaux COM et NCOM sont appliqués à un étage pilote 2 dont la sortie commande un étage inverseur 3. L'étage
30 pilote 2 comprend deux branches en parallèle comportant chacune un transistor PMOS en série avec un transistor NMOS, respectivement T0, T1 et T2, T3. Les sources des transistors T0 et T2 reçoivent la tension VPOS tandis que les sources des transistors T1 et T3 reçoivent la
35 tension VNEG. Le nœud de drain des transistors T2, T3 est

connecté à la grille du transistor T1 et le nœud de drain des transistors T0, T1 est connecté à la grille du transistor T3. L'étage inverseur 3 comprend un transistor PMOS T4 en série avec un transistor NMOS T5. La source du transistor T4 reçoit la tension VPOS et la source du transistor T5 reçoit la tension VNEG. Les grilles des transistors T4, T5 sont reliées au nœud de drain des transistors T2, T3, et le nœud de drains des transistors T4, T5 fournit la tension Vi. Les transistors NMOS T1, T3 et T5 sont réalisés dans un caisson WP de type P isolé du substrat par un caisson N, selon la technique connue de triple caisson.

La fonction de transfert des adaptateurs de tension ADi est décrite par le tableau 1 ci-après. Dans le mode effacement de page (ERASE=1) la tension Vi appliquée à une ligne de mot WLi est égale à VER si la ligne de mot est sélectionnée (SELi=1) ou à VEINHIB si la ligne de mot n'est pas sélectionnée (SELi=0), la tension VEINHIB étant ici égale à 4V. En dehors des périodes d'effacement, la tension Vi appliquée à une ligne de mot WLi sélectionnée est égale à la tension VPOS et la tension Vi appliquée à une ligne de mot WLi non sélectionnée (SELi=0) est nulle.

Tableau 1

Mode	SELi	ERASE	COMN	COM	Vi
Lecture	0	0	0	1	Vi = VNEG = VNREAD = 0V (GND)
	1	0	1	0	Vi = VPOS = VREAD = 4.5V
Programmation	0	0	0	1	Vi = VNEG = VPINHIB = 0V (GND)
	1	0	1	0	Vi = VPOS = VPP (8 - 10V)
Effacement	0	1	1	0	Vi = VPOS = VEINHIB (4V)
	1	1	0	1	Vi = VNEG = VER (-8V)

Un tel décodeur à tension négative, bien qu'apportant en soi toute satisfaction, présente l'inconvénient que les adaptateurs de tension ADi, qui forment les éléments de terminaison du décodeur, sont
5 d'une structure relativement complexe.

Or, avec l'évolution des procédés de fabrication des mémoires Flash, le pas technologique des mémoires ("pitch"), c'est-à-dire la distance minimale entre deux lignes de mot, se réduit de plus en plus. Il apparaît
10 ainsi que la surface de silicium disponible en face de chaque ligne de mot WLi devient trop faible pour permettre l'intégration des adaptateurs de tension ayant la structure décrite ci-dessus.

Ainsi, la présente invention vise une structure de
15 décodeur de ligne de mot à tension négative sélective qui soit compatible avec la réduction du pas technologique dans les mémoires non volatiles, notamment les mémoires Flash.

Plus particulièrement, la présente invention vise
20 une structure de décodeur de ligne de mot à tension négative sélective qui comporte des éléments de terminaison de faible encombrement.

Ces objectifs sont atteints par la prévision d'un décodeur d'adresse pour appliquer sélectivement à des
25 lignes de mot d'un plan mémoire des signaux de polarité variable, négative ou positive, dont la valeur est fonction d'une adresse de ligne de mot appliquée au décodeur, comprenant un décodeur de groupe délivrant des signaux de sélection de groupe de lignes de mot qui sont
30 de polarité variable, au moins un décodeur de sous-groupe délivrant des signaux de sélection de sous-groupe de lignes de mot qui sont également de polarité variable, un sous-groupe de lignes de mot comprenant un ensemble de lignes de mot appartenant à des groupes de lignes de mot
35 différents, et des pilotes de ligne de mot à raison d'un

pilote de ligne de mot par ligne de mot, comprenant chacun des moyens de multiplexage des signaux de sélection de groupe et de sous-groupe, pour sélectionner et appliquer sélectivement un de ces signaux à une ligne
5 de mot.

Selon un mode de réalisation, un groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de mot ayant des bits d'adresse de poids déterminé identiques, et un sous-groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de
10 mot ayant des bits d'adresse de poids déterminé identiques, tout en appartenant à des groupes de lignes de mot différents.

Selon un mode de réalisation, un groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de mot ayant des
15 bits d'adresse de poids fort identiques, et un sous-groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de mot ayant des bits d'adresse de poids faible identiques.

Selon un mode de réalisation, un pilote de ligne de mot comprend des transistors interrupteurs de type MOS
20 qui sont à la fois pilotés sur leur grille et polarisés sur leur drain et leur source par les signaux de sélection de groupe et de sous-groupe, et sont agencés pour sélectionner un de ces signaux et l'appliquer à une ligne de mot.

25 Selon un mode de réalisation, un pilote de ligne de mot comprend des transistors interrupteurs ayant chacun une borne reliée à une ligne de mot, une borne recevant un signal de sélection de groupe ou de sous-groupe, et une grille recevant un signal de sélection de groupe ou
30 de sous-groupe.

Selon un mode de réalisation, le décodeur de sous-groupe comprend un premier décodeur de sous-groupe, délivrant des premiers signaux de sélection de sous-groupe dont la valeur est fonction de l'adresse de ligne
35 de mot appliquée au décodeur pendant des phases

d'effacement de cellules mémoire, et est indépendante de l'adresse appliquée au décodeur pendant des phases de lecture ou de programmation de cellules mémoire ; et un second décodeur de sous-groupe délivrant des seconds
5 signaux de sélection de sous-groupe dont la valeur est fonction de l'adresse de ligne de mot appliquée au décodeur pendant les phases de lecture ou de programmation, et est indépendante de l'adresse appliquée au décodeur pendant les phases d'effacement.

10 Selon un mode de réalisation, chacun des décodeurs de sous-groupe reçoit une première et une seconde tension de référence et fournit, en sus d'un signal de sélection de sous-groupe, un signal complémentaire de sélection de sous-groupe égal à la seconde tension de référence quand
15 le signal de sélection de sous-groupe est égal à la première tension de référence et égal à la première tension de référence quand le signal de sélection de sous-groupe est égal à la seconde tension de référence.

Selon un mode de réalisation, un pilote de ligne de
20 mot comprend des transistors MOS dont les grilles sont pilotées par l'un des signaux complémentaires, et des transistors MOS dont les grilles sont pilotées par des signaux de sélection de groupe.

Selon un mode de réalisation, un pilote de ligne de
25 mot comprend un premier transistor MOS ayant une borne de drain ou de source reliée à une ligne de mot, recevant sur sa grille un signal de sélection de groupe et recevant sur une borne de source ou de drain un premier signal de sélection de sous-groupe, un deuxième
30 transistor MOS ayant une borne de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant sur sa grille le signal de sélection de groupe et recevant sur une borne de source ou de drain un second signal de sélection de sous-groupe, un troisième transistor MOS ayant une borne
35 de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant

sur sa grille un premier signal complémentaire de sélection de sous-groupe et recevant sur une borne de source ou de drain un second signal de sélection de sous-groupe, et un quatrième transistor MOS ayant une borne de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant sur sa grille un second signal complémentaire de sélection de sous-groupe et recevant sur une borne de source ou de drain un premier signal de sélection de sous-groupe.

Selon un mode de réalisation, les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence qui sont respectivement égales à une tension de non-lecture et à une tension de lecture pendant la lecture de cellules mémoire.

Selon un mode de réalisation, les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence qui sont respectivement égales à une tension d'inhibition de programmation et à une tension de programmation pendant la programmation de cellules mémoire.

Selon un mode de réalisation, les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence qui sont respectivement égales à une tension d'effacement et à une tension d'inhibition d'effacement pendant l'effacement de cellules mémoire.

Selon un mode de réalisation, la tension de programmation est positive, la tension d'inhibition de programmation et la tension d'effacement sont négatives, les tensions de non lecture et d'inhibition d'effacement sont nulles.

Selon un mode de réalisation, le décodeur comprend un étage de prédécodage fournissant des signaux de prédécodage aux décodeurs de groupe et de sous-groupe.

Selon un mode de réalisation, le décodeur de groupe et le décodeur de sous-groupe fournissent des signaux de sélection positifs, négatifs ou nuls.

Selon un mode de réalisation, le décodeur de groupe comprend des circuits éleveurs de tension pour transformer un signal logique égal à 1 ayant un niveau de tension positif déterminé en un signal logique ayant un
5 niveau de tension positif de valeur supérieure, égal à une tension de référence fournie aux circuits éleveurs de tension.

Selon un mode de réalisation, les décodeurs de groupe et de sous-groupe comprennent des commutateurs de
10 tension pour transformer des signaux logiques à 0 et à 1 en des signaux ayant des niveaux de tension négatifs différents.

Selon un mode de réalisation, les décodeurs de groupe et de sous-groupe comprennent des commutateurs de
15 tension agencés pour transformer un signal logique à 0 en un signal de tension négative et signal logique à 1 en un signal de tension positive.

Ces objets, caractéristiques et avantages ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés plus en
20 détail dans la description suivante d'un exemple de réalisation d'un décodeur selon l'invention, faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

- la figure 1 précédemment décrite représente la
25 structure générale d'un décodeur de ligne de mot à tension négative classique,
- la figure 2 représente la structure d'un adaptateur de tension présent dans le décodeur de la figure 1,
- la figure 3A représente la structure générale d'un
30 décodeur de ligne de mot selon l'invention, intégré dans une mémoire Flash,
- la figure 3B représente un générateur de tension d'alimentation représenté sous forme de bloc en figure 3A,

- la figure 4 représente la structure d'un pilote de ligne de mot représenté sous forme de bloc en figure 3A,
- les figures 5A à 5L représentent le pilote de ligne de mot de la figure 4 dans diverses configurations de fonctionnement,
- la figure 6 représente l'architecture d'un décodeur de groupe représenté sous forme de bloc en figure 3A,
- la figure 7 représente l'architecture d'un premier décodeur de sous-groupe représenté sous forme de bloc en figure 3A,
- la figure 8 représente l'architecture d'un second décodeur de sous-groupe représenté sous forme de bloc en figure 3A,
- la figure 9 est le schéma électrique d'un circuit élévateur de tension représenté sous forme de bloc en figure 6, et
- la figure 10 est le schéma électrique d'un commutateur de tension négative représenté sous forme de bloc en figures 6, 7 et 8.

La figure 3A est un schéma d'ensemble d'une mémoire Flash comprenant un décodeur de ligne de mot WLDEC2 selon l'invention et un plan mémoire Flash MA. Le décodeur WLDEC2 reçoit ici une adresse de ligne de mot ADR codée sur 11 bits A0 à A10. Le plan mémoire MA comprend des lignes de mot WLi,j, des lignes de bit BLk (i, j, k étant des indices) et des transistors à grille flottante FGT. Chaque transistor FGT a une grille connectée à une ligne de mot et une borne de drain ou de source connectée à une ligne de bit, et forme une cellule mémoire effaçable et programmable électriquement. Les lignes de bit BLk sont reliées à un circuit de programmation PLCT et à un circuit de lecture SENSECT. Le circuit PLCT comprend des verrous de programmation, pour recevoir des données DTin à enregistrer dans les cellules mémoire lors d'une phase de programmation. Le circuit de lecture SENSECT comprend

des amplificateurs de lecture ("sense amplifiers") pour lire des données DTout dans les cellules mémoire lors d'une phase de lecture.

Organisation du plan mémoire

5 Le plan mémoire comprend ici 8 secteurs SCT0 à SCT7 désignés par les 3 bits d'adresse de plus fort poids A0-A2, et chaque secteur comprend 256 lignes de mot (seul le secteur SCT6 étant représenté de façon partielle). Ce découpage en secteurs est toutefois optionnel et n'est
10 décrit ici qu'à titre d'exemple concret de mise en œuvre de l'invention.

L'architecture du décodeur WLDEC2 repose sur un découpage de chaque secteur (ou du plan mémoire dans sa totalité si un seul secteur est prévu) en groupes de
15 lignes de mot et en sous-groupes de lignes de mot, tels que l'intersection d'un groupe de lignes de mot et d'un sous-groupe de lignes de mot corresponde à une ligne de mot et une seule.

Ce découpage est effectué ici ainsi :

- 20 - les 5 bits d'adresse de poids forts A3-A7 désignent un groupe de ligne de mot, et
- les 3 bits d'adresse de plus faible poids A8-A10 désignent un sous-groupe de lignes de mot.

Naturellement, les bits d'adresse de plus fort
25 poids A0-A2 seraient des bits de désignation de groupe si le plan mémoire ne comportait pas de secteur.

Chaque secteur comprend ainsi 32 groupes de 8 lignes de mot et 8 sous-groupes de 8 lignes de mot, et chaque groupe comprend 8 lignes de mot qui appartiennent
30 chacune à l'un des 8 sous-groupes, un sous-groupe ne comprenant que des lignes de mot appartenant à des groupes différents. Dans ce qui suit, un groupe est désigné GRPi et le rang d'un groupe désigné par l'indice "i", le rang d'un sous-groupe étant désigné par l'indice
35 "j". Une ligne de mot appartenant à un groupe de rang i

et à un sous-groupe de rang j est désignée WLi,j . La figure 3A représente à titre d'exemple les lignes de mot $WLi,0...WLi,j...WLi,7$ d'un groupe $GRPi$ de rang i du secteur SCT6 (l'indice i étant compris ici entre 0 et 5 31).

Architecture du décodeur WLDEC2

Le décodeur WLDEC2 présente une architecture correspondant au découpage du plan mémoire en groupes et en sous-groupes, et comprend :

- 10 - un prédécodeur PREDEC1 alimenté par une tension V_{cc} ,
- un décodeur de groupe GPGEN selon l'invention,
- deux décodeurs de sous-groupe DECGEN, SPGEN selon l'invention,
- des pilotes de ligne de mot Di,j ("Word line drivers")
- 15 selon l'invention, à raison d'un pilote Di,j par ligne de mot, chaque pilote de ligne de mot fournissant une tension Vi,j à une ligne de mot WLi,j de rang correspondant.

Prédécodeur PREDEC1

- 20 Le prédécodeur PREDEC1 fournit au décodeur de groupe GPGEN des signaux de sélection de groupe $Lx(a)$, $Ly(b)$, LBS.

Le signal LBS est fonction des 3 bits d'adresse de plus fort poids $A0-A2$ et est identique pour tous les groupes de lignes de mot d'un même secteur. Si par exemple les bits d'adresse $A0-A2$ désignent le secteur SECT6, le signal $LBS(S6)$ fourni par le prédécodeur pour tous les groupes de lignes de mot de ce secteur est à 1.

Les signaux $Lx(a)$, $Ly(b)$ sont fonction des 5 bits d'adresse de poids forts $A3-A7$ et comprennent ici 8 30 signaux $Lx(0)$ à $Lx(7)$ et 4 signaux $Ly(0)$ à $Ly(3)$, permettant d'obtenir 32 combinaisons différentes de signaux, en commençant par la combinaison $Lx(0)/Ly(0)$ et en terminant par la combinaison $Lx(7)/Ly(3)$. Ainsi,

chaque combinaison de signaux $Lx(a)$, $Ly(b)$ correspond à un groupe et un seul parmi les 32 groupes du secteur.

Le prédécodeur PREDEC1 fournit également des signaux de sélection de sous-groupe PD_j qui sont appliqués au décodeur de sous-groupe DECGEN, ici 8 signaux de sélection PD_0 à PD_7 , et des signaux de sélection de sous-groupe PS_j qui sont appliqués au décodeur de sous-groupe SPGEN, ici 8 signaux de sélection PS_0 à PS_7 . Ces signaux sont fonction des 3 bits d'adresse de plus faible poids A_8 - A_{10} .

Le prédécodeur PREDEC1 comprend 8 blocs de prédécodage $PREDEC1(S_0)$ à $PREDEC1(S_7)$, à raison d'un bloc par secteur, chaque bloc de décodage étant relié à un bloc de décodage du décodeur GPGEN décrit ci-après. Les signaux fournis par le bloc $PREDEC(S_6)$ sont partiellement représentés sur la figure 3A.

Décodeur de groupe GPGEN

Le décodeur de groupe GPGEN comprend un bloc de décodage par secteur, soit ici 8 blocs de décodage $GPGEN(S_0)$ à $GPGEN(S_7)$. Chaque bloc de décodage comprend des éléments de décodage $GPGEN_i$ en nombre égal au nombre de groupes de lignes de mot par secteur, soit ici 32 éléments de décodage $GPGEN_0$ à $GPGEN_{31}$. Les éléments de décodage du bloc $GPGEN(S_6)$ sont partiellement représentés en figure 3A. Chaque élément de décodage $GPGEN_i$ de rang "i" fournit un signal de sélection GPI appliqué à tous les pilotes de ligne de mot Di,j ($Di,0$ à $Di,7$) du groupe de lignes de mot GRP_i de rang correspondant.

Chaque élément de décodage $GPGEN_i$ reçoit une combinaison de trois signaux de sélection $Lx(a)$, $Ly(b)$, LBS. Par exemple, l'élément de décodage $GPGEN_0$ du bloc $GPGEN(S_6)$ reçoit la combinaison $Lx(0)/Ly(0)/LBS(S_6)$ et l'élément de décodage $GPGEN_{31}$ reçoit la combinaison $Lx(7)/Ly(3)/LBS(S_6)$, le signal LBS étant identique pour toutes les lignes de mot du même secteur. Les signaux

Lx(a), Ly(b) étant fonction des 5 bits d'adresse de poids forts A3-A7, un seul élément de décodage de groupe GPGENi dans chaque bloc de décodage reçoit une combinaison de signaux Lx(a)/Ly(b) égale à "11" (Vcc), et un seul
 5 élément de décodage GPGENi parmi tous les blocs de décodage reçoit une combinaison de signaux Lx(a)/Ly(b)/LBS égale à "111".

Décodeur de sous-groupe DECGEN

Le décodeur de sous-groupe DECGEN comprend un bloc
 10 de décodage par secteur, soit ici 8 blocs de décodage DECGEN(S0) à DECGEN(S7). Chaque bloc de décodage comprend des éléments de décodage DECGENj en nombre égal au nombre de sous-groupes de lignes de mot par secteur, soit ici 8 éléments de décodage DECGEN0 à DECGEN7. Les éléments de
 15 décodage du bloc SPGEN(S6) sont partiellement représentés sur la figure 3A.

Chaque élément de décodage DECGENj de rang j reçoit un signal de sélection PDj de rang correspondant et le signal LBS de sélection du secteur correspondant. Par
 20 exemple, les éléments de décodage DECGEN0 et DECGEN7 du bloc DECGEN(S6) reçoivent respectivement des signaux de sélection PD0 et PD7 et le signal LBS(S6). Les signaux de sélection PD0 à PD7 sont communs à tous les blocs DECGEN(S0) à DECGEN(S7).

25 Chaque élément de décodage DECGENj de rang j fournit des signaux de sélection DECj, DECNj. Ces signaux de sélection sont appliqués aux pilotes de ligne de mot Di,j des lignes de mot appartenant au même sous-groupe de rang j. Les lignes de mot d'un même groupe GRPi
 30 appartenant chacune à un sous-groupe différent, les pilotes de ligne de mot Di,j reliés à ces lignes de mot reçoivent chacun une combinaison de signaux de sélection DECj, DECNj individuelle.

Décodeur de sous-groupe SPGEN

Le décodeur de sous-groupe SPGEN, d'une architecture d'ensemble similaire à celle du décodeur de sous-groupe DECGEN, comprend un bloc de décodage par secteur, soit ici 8 blocs de décodage SPGEN(S0) à SPGEN(S7). Chaque bloc de décodage comprend des éléments de décodage SPGENj en nombre égal au nombre de sous-groupes de lignes de mot par secteur, soit ici 8 éléments de décodage SPGEN0 à SPGEN7. Les éléments de décodage du bloc SPGEN(S6) sont partiellement représentés sur la figure 3A.

Chaque élément de décodage SPGENj de rang j reçoit un signal de sélection PSj de rang correspondant et le signal LBS de sélection du secteur correspondant. Par exemple, les éléments de décodage SPGEN0 et SPGEN7 du bloc SPGEN(S6) reçoivent respectivement des signaux de sélection PS0 et PS7 et le signal LBS(S6). Les signaux de sélection PS0 à PS7 sont communs à tous les blocs SPGEN(S0) à SPGEN(S7).

Chaque élément de décodage SPGENj de rang j fournit des signaux de sélection SPj, SPNj. Ces signaux de sélection sont appliqués aux pilotes de ligne de mot Di,j des lignes de mot appartenant au même sous-groupe de rang j. Les lignes de mot d'un même groupe GRPi appartenant chacune à un sous-groupe différent, les pilotes de ligne de mot Di,j reliés à ces lignes de mot reçoivent chacun une combinaison de signaux de sélection SPj, SPNj individuelle.

Pilote de ligne de mot Di,j

A l'inverse du décodeur classique précédemment décrit, les pilotes de ligne de mot Di,j selon l'invention ne convertissent pas un signal de sélection du type 0/Vcc en une tension négative ou positive selon l'opération effectuée dans le plan mémoire (lecture, effacement, programmation). Les pilotes de ligne de mot

sont ici de simples multiplexeurs de signaux dont la fonction est de combiner les signaux de polarité variable fournis par les éléments de décodage de groupe GPGEN_i et les éléments de décodage de sous-groupe DECGEN_j, SPGEN_j, soit les signaux GPI, SP_j et SPN_j, DEC_j et DECN_j, pour obtenir des tensions $V_{i,j}$ de polarité variable à appliquées aux lignes de mot $W_{Li,j}$. Les pilotes de ligne de mot peuvent être ainsi d'une structure très simple.

La figure 4 représente un mode de réalisation d'un pilote de ligne de mot $D_{i,j}$ nécessitant un faible nombre de transistors. Le pilote de ligne de mot $D_{i,j}$ comprend deux transistors interrupteurs PMOS TP1, TP2 et deux transistors interrupteurs NMOS TN1, TN2 agencés pour combiner les signaux GPI, SP_j et SPN_j, DEC_j et DECN_j. Les transistors PMOS et NMOS sont implantés dans des caissons différents (respectivement caissons de type N et caissons de type P) d'une manière qui est en soi à la portée de l'homme de l'art et ne sera pas décrite ici.

Les transistors TP1, TP2 reçoivent sur leurs sources le signal SP_j et les transistors TN1, TN2 reçoivent sur leurs sources le signal DEC_j. Les grilles des transistors TP1, TN1 reçoivent le signal GPI. La grille du transistor TP2 reçoit le signal DECN_j et la grille du transistor TN2 reçoit le signal SPN_j. Les drains des transistors TP1, TP2, TN1, TN2 sont connectés à un nœud de sortie du pilote de ligne de mot, qui fournit la tension $V_{i,j}$ à la ligne de mot correspondante $W_{Li,j}$.

Les pilotes de ligne de mot $D_{i,j}$ sont ainsi de faible encombrement et sont adaptés à la réduction du pas technologique dans les mémoires en circuit intégré. La fourniture des tensions négatives ou positives est assurée par les décodeurs de groupe GPGEN et de sous-groupe DECGEN, SPGEN. De ce fait, la partie du décodeur selon l'invention assurant le postdécodage des signaux de

prédécodage, comprenant ici les décodeurs GPGEN, DECGEN et SPGEN, est d'une structure plus complexe que celle d'un postdécodeur à tension positive, comme cela apparaîtra plus loin. Toutefois, la surface de silicium disponible pour réaliser les décodeurs de groupe et de sous-groupe est nettement plus étendue que celle qui est imposée par le pas technologique entre les lignes de mot, puisque chaque groupe ou sous-groupe couvre un ensemble de lignes de mot. La présente invention repose ainsi sur une complexification de la partie amont du décodeur, au profit d'une simplification de sa partie aval, qui est formée par les pilotes de ligne de mot.

Afin de fournir des signaux de polarité variable, les décodeurs GPGEN, SPGEN, DECGEN reçoivent des tensions VPOS et VNEG fournies par un générateur de tension PWGEN contrôlé par un séquenceur SEQ.

Générateur de tension PWGEN et séquenceur SEQ

Le générateur PWGEN et le séquenceur SEQ sont représentés plus en détail sur la figure 3B, qui complète la figure 3A. Le générateur PWGEN comprend une pompe de charges PMP1 délivrant la tension VNEG, une pompe de charges délivrant la tension VPOS, un régulateur REG1 pour contrôler la tension VNEG et un régulateur REG2 pour contrôler la tension VPOS. Ces divers éléments du générateur PWGEN sont commandés par un circuit de contrôle CONTCT. Les tensions VPOS, VNEG sont appliquées aux décodeurs GPGEN, SPGEN, DECGEN.

Le circuit de contrôle CONTCT est piloté par un signal de mode MDS qui est fourni par le séquenceur SEQ en réponse à une commande CMD de lecture ou d'écriture du plan mémoire appliquée au séquenceur. Le séquenceur SEQ, à logique câblée ou à microprocesseur, fournit également des signaux SES ("Sector Erase Signal") et INVSEL ("Inverse Selection"). Les signaux MDS, SES sont

appliqués au prédécodeur PREDEC1. Le signal INVSEL est appliqué au décodeur de groupe GPGEN.

Fonctionnement du décodeur WLDEC2

Le fonctionnement du décodeur WLDEC2 est décrit par le tableau 2 ci-après. On distingue dans ce tableau les colonnes suivantes :

Colonne "Modes"

Cette colonne décrit les modes de fonctionnement de la mémoire. On distingue un mode READ correspondant à la lecture de cellules mémoire, un mode PROG correspondant à la programmation de cellules mémoire, un mode PERASE ("Page Erase") correspondant à l'effacement d'une page (ligne de mot) du plan mémoire, et un mode SERASE ("Sector Erase") correspondant à l'effacement de tout un secteur. Ce dernier mode d'effacement est celui des mémoires Flash classiques n'ayant pas de décodeur à tension négative sélective.

Colonne "SES"

Cette colonne décrit la valeur du signal SES ("Sector Erase Signal"). Ce signal détermine si une opération d'effacement doit être appliquée à tout un secteur (mode SERASE) ou seulement à une page du plan mémoire (mode PERASE). Le signal SES est mis à 1 en réponse à une commande d'effacement par secteur (mode SERASE) et à 0 en réponse à une commande d'effacement par page (mode PERASE). Sa valeur par défaut est 0 dans les modes PROG et READ.

Colonne "MDS"

Cette colonne décrit la valeur du signal de mode MDS, qui comprend ici deux bits B1, B2. Le bit B1 est mis à 1 quand la tension VNEG doit être portée à une valeur négative et est mis à 0 quand la tension VNEG doit être mise à 0 (masse). Le bit B2 est mis à 0 quand la tension VPOS doit être portée à une valeur positive et est mis à 1 quand la tension VPOS doit être mise à 0 (masse).

Colonne "INVSEL"

Cette colonne décrit la valeur du signal INVSEL ("Inverse Selection"), qui est à 0 dans les modes READ et PROG et à 1 dans les modes PERASE et SERASE. Le signal INVSEL permet d'inhiber les signaux PDj dans les modes READ et PROG et d'inhiber les signaux PSj dans les modes PERASE et SERASE. Plus particulièrement, les signaux PDj sont forcés à 0 dans le mode READ et sont forcés à 1 dans le mode PROG, tandis que les signaux PSj sont forcés à 1 dans les modes PERASE et SERASE. Cela permet d'inhiber le décodeur de sous-groupe DECGEN dans les modes READ et PROG afin de porter les signaux DECj, DECNj à des valeurs fixes et prédéterminées décrites par le tableau 2. Cela permet également d'inhiber le décodeur de sous-groupe SPGEN dans les modes PERASE et SERASE afin de porter les signaux SPj, SPNj à des valeurs fixes et prédéterminées décrites par le tableau 2.

Colonne "VNEG"

Cette colonne décrit la valeur de la tension VNEG dans les quatre modes de fonctionnement du décodeur. Dans le mode READ, la tension VNEG est égale à une tension de non-lecture VNREAD qui est ici égale à 0V. Dans le mode PROG, la tension VNEG est égale à une tension d'inhibition de programmation VPINHIB qui est ici égale à -1,5V. Dans le mode PERASE et SERASE, la tension VNEG est égale à une tension d'effacement négative VER qui est ici égale à -9V.

Colonne "VPOS"

Cette colonne décrit la valeur de la tension VPOS dans les quatre modes de fonctionnement du décodeur. Dans le mode READ, la tension VPOS est égale à une tension de lecture VREAD qui est ici égale à 4,5V. Dans le mode PROG, la tension VPOS est égale à une tension de programmation VPP qui est ici égale à 7,5V. Dans le mode

PERASE et SERASE, la tension VPOS est égale à une tension d'inhibition d'effacement VEINHIB qui est ici égale à 0V.

Colonne "état"

Cette colonne décrit l'état sélectionné (SEL) ou non sélectionné (UNS) d'une ligne de mot, en fonction des signaux de prédécodage Lx(a), Ly(b), PSj, PDj fournis par le prédécodeur.

Colonnes "Lx(a)", "Ly(b)", "PSj", "PDj"

Ces colonnes décrivent, dans les quatre modes de fonctionnement du décodeur, des exemples de valeurs de signaux de prédécodage pour des lignes de mot sélectionnées ou non sélectionnées. Comme indiqué plus haut, le signal PDj est forcé à 0 dans le mode READ et est forcé à 1 dans le mode PROG, tandis que le signal PSj est forcé à 1 dans les modes PERASE et SERASE. Une ligne de mot WLi,j est dans l'état sélectionné lorsque les signaux de prédécodage correspondants Lx(a), Ly(b), PSj (modes READ, PROG) ou Lx(a), Ly(b), PDj (modes PERASE, SERASE) sont simultanément à 1. Le signal de sélection LBS n'est pas décrit dans un souci de simplicité, et l'on considère que le tableau 2 décrit les opérations intervenant dans un secteur sélectionné (LBS=1).

Colonnes "GPi", "SPj", "SPNj", "DECj", "DECNj"

Ces colonnes décrivent, dans les quatre modes de fonctionnement du décodeur, les valeurs des signaux GPi, SPj, SPNj, DECj, DECNj correspondant aux valeurs des signaux de prédécodage Lx(a), Ly(b), PSj, PDj et aux valeurs des tensions VNEG et VPOS. Ces signaux sont exprimés en Volt et correspondent aux valeurs attribuées aux tensions VNEG et VPOS, soit VNREAD et VREAD dans le mode READ, VPINHIB et VPP dans le mode PROG, VER et VEINHIB dans les modes PERASE et SERASE, soit ici 0V et 4,5 V, -1,5V et 7,5V, -9V et 0V, respectivement. Les signaux DECj et DECNj sont forcés à 0V et 4,5V dans le mode READ car le signal de prédécodage PDj est forcé à 0,

et sont forcés à -1,5V et 7,5V dans le mode PROG car le signal de prédécodage PDj est forcé à 1. De même les signaux SPj et SPNj sont forcés à 0 et -9V dans les modes PERASE et SERASE car le signal de prédécodage PSj est
5 forcé à 1.

On notera que le signal DECNj est l'inverse du signal DECj et que le signal SPNj est l'inverse du signal SPj, dans un système de signaux logiques où les tensions VNEG et VPOS définissent respectivement le 0 et le 1
10 logique.

Colonne "Vi,j"

Cette colonne décrit la valeur de la tension Vi,j appliquée à une ligne de mot sélectionnée ou non sélectionnée, dans chacun des modes de fonctionnement.
15 Dans le mode READ, une ligne de mot sélectionnée reçoit la tension de lecture VREAD (ici 4,5V) tandis qu'une ligne non sélectionnée reçoit la tension de non-lecture VNREAD (ici 0V). Dans le mode PROG, une ligne de mot sélectionnée reçoit la tension de programmation ou
20 rafraîchissement VPP (ici 7,5V) tandis qu'une ligne de mot non sélectionnée reçoit la tension d'inhibition de programmation VPINHIB (ici -1,5V) qui protège les cellules mémoire contre un stress de drain pouvant entraîner une programmation parasite. Dans le mode
25 PERASE, une ligne de mot sectionnée (formant la page à effacer) reçoit la tension d'effacement négative VER (ici -9V) tandis qu'une ligne de mot non sélectionnée reçoit la tension d'inhibition d'effacement VEINHIB (ici 0V). Cette tension protège les cellules mémoire contre un
30 effacement parasite en faisant diminuer la différence de tension source-grille des transistors à grille flottante, car une tension positive est appliquée sur les sources des toutes les cellules mémoire du secteur, comme décrit dans la demande WO 02/41322. Dans le mode PERASE, toutes
35 les lignes de mot du secteur sélectionné reçoivent la

tension d'effacement négative VER tandis que les lignes de mot des autres secteurs reçoivent la tension d'inhibition d'effacement VEINHIB.

Colonne "Figures 5A - 5L"

5 Les figures 5A à 5L illustrent le fonctionnement d'un pilote de ligne de mot $D_{i,j}$ dans chacune des configurations électriques décrites par le tableau 2, respectivement. On voit sur ces figures que la valeur du signal $V_{i,j}$ fournit à la ligne de mot dépend de la
10 combinaison des signaux G_{Pi} , SP_j , SPN_j , DEC_j , $DECN_j$, un des transistors $TP1$, $TP2$, $TN1$, $TN2$, parfois deux, étant passant et les autres bloqués, le ou les transistors passants assurant le cheminement d'un des signaux SP_j , DEC_j jusqu'au nœud de sortie (les signaux G_{Pi} , SPN_j ,
15 $DECN_j$ étant utilisés ici comme signaux de commande de grille). Les tensions appliquées aux caissons P et N des transistors ne sont pas représentées dans un souci de simplicité, à l'exception de la configuration de la figure 5F où il doit être signalé qu'une tension de 7,5 V
20 appliquée au caisson du transistor $TP1$ permet de maintenir ce transistor dans l'état bloqué.

En résumé, le décodeur selon l'invention permet de prévoir des pilotes de ligne de mot $D_{i,j}$ d'une structure simple et compatible avec les mémoires à haute densité de
25 lignes de mot, pour appliquer des tensions négatives ou positives de façon sélective à ces lignes de mot.

On décrira maintenant des exemples de réalisation d'un élément de décodage de groupe $GPGEN_i$, d'un élément de décodage de sous-groupe $SPGEN_j$ et d'un élément de
30 décodage de sous-groupe $DECGEN_j$. Dans ce qui suit, les transistors de type NMOS sont désignés par des signes de référence commençant par "TN" et les transistors de type PMOS par des signes de référence commençant par "TP".

Elément de décodage de groupe GPGENi

La figure 6 représente un élément GPGENi, fournissant un signal de sélection de groupe GPi. L'élément GPGENi comprend une porte A1 de type ET recevant en entrée les signaux Lx(a), Ly(b), LBS, dont la sortie est appliquée sur une entrée d'une porte XO1 de type OU Exclusif, qui reçoit sur son autre entrée le signal INVSEL. La sortie de la porte XO1 fournit un signal GPATVPOS ("GPi at VPOS") appliqué à une porte inverseuse I1 dont la sortie fournit un signal GPATVNEG ("GPi at VNEG"). Ces diverses portes logiques sont alimentées par la tension Vcc et les signaux logiques GPATVPOS, GPATVNEG sont du type 0/Vcc.

L'élément GPGEN comprend également une branche d'élévation de tension comprenant en série un transistor TP10, un transistor TP11, et un transistor TN10. La tension VPOS est appliquée à la source du transistor TP10 dont le drain est connecté à la source du transistor TP11. Le drain du transistor TP11 est connecté au drain du transistor TN10 dont la source reçoit la tension VNEG. Le transistor TP11 est un transistor cascode dont la grille est par exemple reliée à la masse.

Le signal GPi est fourni par le nœud de drain des transistors TP11 et TN10, formant la sortie de l'élément GPGENi. Ce nœud de drain est par ailleurs relié à la masse par deux transistors TN11, TN12 en série. La grille du transistor TN12 est pilotée par le signal INVSEL.

L'élément GPGENi comprend également un circuit élévateur de tension ELVCT alimenté par la tension VPOS. Le circuit ELVCT comporte une entrée IN1 recevant le signal GPATVPOS, une entrée IN2 recevant le signal GPATVNEG et une sortie OUTN qui pilote la grille du transistor TP10. La sortie OUTN, qui est une sortie inverseuse relativement à l'entrée IN1, délivre un signal égal à VPOS quand l'entrée IN1 est à 0, et un signal égal

à 0 quand l'entrée IN1 est à 1 (Vcc) (Cf. tableau 7 décrit plus bas).

L'élément GPGENi comprend également un circuit commutateur de tension négative NEGSW alimenté par les tensions Vcc et VNEG. Le circuit NEGSW comporte une
5 entrée IN sur laquelle le signal GPATVNEG est appliqué, une sortie non inverseuse OUT de bas niveau qui pilote la grille du transistor TN10, une sortie inverseuse OUTHN de haut niveau qui pilote la grille du transistor TN11. Le
10 circuit NEGSW comporte également une sortie inverseuse OUTN de bas niveau et une sortie non inverseuse OUTH de haut niveau, non utilisées ici. Les tensions délivrées par ces diverses sorties en fonction du signal appliqué sur l'entrée IN sont décrites par le tableau 8 ci-après,
15 certaines étant fonction du mode de fonctionnement de la mémoire.

La valeur du signal de sélection GPi, égale à VPOS, VNEG ou 0, est fonction des signaux Lx(a), Ly(b), LBS, INVSEL, comme décrit par le tableau 2 et les tableaux 3
20 et 4 ci-après, dans lesquels on considère que LBS=1. Dans le mode PERASE ou SERASE (VPOS=0), la mise à 0 du signal GPi est assuré par le transistor TN11 lorsque la sortie OUTHN du circuit NEGSW passe à Vcc, car le signal INVSEL est à 1 et le transistor TN12 est passant (Cf. dernière
25 ligne du tableau 4).

Elément de décodage de sous-groupe DECGENj

La figure 7 représente un élément de décodage de sous-groupe DECGENj, fournissant un signal de sélection de sous-groupe DECj et son complément DECNj. L'élément
30 DECGENj comprend une porte NA1 de type NON ET alimentée par la tension Vcc, recevant en entrée les signaux LBS et PDj. La sortie de la porte NA1 est appliquée sur l'entrée IN d'un circuit commutateur de tension négative NEGSW, conforme à celui décrit plus haut et alimenté par les
35 tensions Vcc et VNEG. La sortie OUTH du circuit NEGSW est

appliquée à la grille d'un transistor TN20 dont le drain est connecté à la masse. La sortie OUTN est appliquée à la grille d'un transistor TN21 dont la source reçoit la tension VNEG. Les transistors TN20, TN21 sont agencés en série et leur nœud de drain fournit le signal DECj. Le signal DECn_j est fourni par une porte inverseuse I2 alimentée par les tensions VPOS et VNEG, dont l'entrée reçoit le signal DECj. Dans le mode PERASE, le signal DECj est ainsi égal à 0 ou à VNEG (-9V) et le signal DECn_j égal à 0 (VPOS=0) ou à VNEG, selon la valeur du signal PDj, comme décrit par le tableau 2 et le tableau 5 ci-après, dans lesquels on suppose que LBS=1.

Élément de décodage de sous-groupe SPGEN_j

La figure 8 représente un élément de décodage de sous-groupe SPGEN_j, fournissant un signal de sélection de sous-groupe SPj et son complément SPNj. L'élément SPGEN_j comprend une porte A2 de type ET alimentée par la tension Vcc, recevant en entrée les signaux LBS et PSj. La sortie de la porte A2 est appliquée sur l'entrée IN d'un circuit commutateur de tension négative NEGSW du type déjà décrit, alimenté par les tensions VNEG et Vcc, dont la sortie OUT pilote la grille d'un transistor TN30 recevant la tension VNEG sur sa source. La sortie de la porte A2 est également appliquée sur l'entrée IN1 d'un circuit élévateur de tension ELVCT du type déjà décrit, alimenté par la tension VPOS, dont la sortie OUTN fournit le signal SPj. Le signal SPj est appliqué sur la grille d'un transistor TP3 dont la source reçoit la tension VPOS. Le drain du transistor TP30 est connecté à la source d'un transistor cascode TP31 dont la grille est reliée à la masse. Le drain du transistor TP31 est relié au drain du transistor TN30. Le signal SPNj est prélevé sur le nœud de drain des transistors TP31, TN30.

Dans le mode READ ou PROG, le signal SPj est ainsi égal à 0 ou à VPOS (avec VPOS = VREAD ou VPP) et le

signal DECNj est égal à VPOS ou VNEG (avec VNEG = VNREAD ou VPINHIB), selon la valeur du signal PSj, comme décrit par le tableau 2 et le tableau 6 ci-après, dans lesquels on suppose que LBS=1.

5 Circuit élévateur de tension ELVCT

La figure 9 représente un exemple de réalisation du circuit élévateur de tension ELVCT. Le circuit ELVCT comprend deux branches en parallèle comprenant chacune deux transistors en série, respectivement TP40, TN40 et
10 TP41, TN41, les sources des transistors TP40, TP41 recevant la tension VPOS et les sources des transistors TN40, TN41 étant connectées à la masse. La grille du transistor TP40 est connectée au drain du transistor TP41 dont la grille est connectée au drain du transistor TP40.
15 La grille du transistor TN41 forme l'entrée IN1 et la grille du transistor TN40 forme l'entrée IN2 du circuit ELVCT. Le nœud de drain des transistors TP41, TN41 forme la sortie OUTN du circuit ELVCT. La sortie OUTN fournit un signal égal à VPOS quand l'entrée IN1 reçoit un signal
20 égal à 0V et l'entrée IN2 reçoit un signal égal à Vcc, et fournit un signal égal à 0V quand l'entrée IN1 reçoit un signal égal à Vcc et l'entrée IN2 reçoit un signal égal à 0V. Le circuit ELVCT forme une sorte de bascule flip-flop assurant le verrouillage de la sortie OUTN tout en
25 assurant une élévation de tension du niveau logique 1, comme décrit par le tableau 7 ci-après.

Commutateur de tension négative NEGSW

La figure 10 représente un exemple de réalisation du commutateur de tension négative NEGSW. Celui-ci
30 comprend deux branches en parallèle comportant chacune trois transistors, respectivement TP50, TN50, TN51 et TP51, TN52, TN53. L'entrée IN du commutateur NEGSW est connectée à la source du transistor TP50 et est reliée à la source du transistor TP51 par l'intermédiaire d'une
35 porte inverseuse I3 alimentée par la tension Vcc. Le

drain du transistor TP50 est connecté au drain du transistor TN50. La source du transistor TN50 est reliée au drain du transistor TN51 dont la source reçoit la tension VNEG. Le drain du transistor TP51 est connecté au drain du transistor TN52. La source du transistor TN52 est reliée au drain du transistor TN53 dont la source reçoit la tension VNEG. Les transistors TP50, TP51 sont des transistors cascode et ont leurs grilles reliées à la masse. Les transistors TN50, TN52 sont également des transistors cascode et leurs grilles sont polarisées par une tension VCASC. La grille du transistor TN53 est connectée au drain du transistor TN51 et la grille du transistor TN51 est reliée au drain du transistor TN53.

La sortie de bas niveau OUT du commutateur de tension négative est connectée au drain du transistor TN51 et la sortie inverseuse de bas niveau OUTN est connectée au drain du transistor TN53. La sortie de haut niveau OUTH est connectée au drain du transistor TP51 et la sortie inverseuse de haut niveau OUTHN est connectée au drain du transistor TP51. Lorsque la tension Vcc est appliquée sur l'entrée IN le transistor TN51 est passant et le transistor TN53 est bloqué. Lorsque l'entrée IN est mise à 0 le transistor TN51 est bloqué, la sortie de la porte I3 fournit la tension Vcc et le transistor TN53 est passant. Le commutateur NEGSW fonctionne ainsi comme une sorte de bascule flip-flop qui bascule dans un sens quand l'entrée IN reçoit la tension Vcc, et dans l'autre sens quand l'entrée IN reçoit une tension nulle. Les tensions délivrées par les sorties OUT, OUTN, OUTH, OUTHN sont décrites par le tableau 8 ci-après. On notera que les tensions délivrées par les sorties de bas niveau OUT, OUTN dépendent de la valeur de la tension VCASC et que celle-ci présente des valeurs différentes selon le mode de fonctionnement de la mémoire. La tension VCASC est ainsi égale à VPOS dans les modes de fonctionnement READ

et PROG (soit quand la tension VNEG est égale à 0 ou à -1,5V) et est égale à 0 dans les modes de fonctionnement PERASE, SERASE (soit quand la tension VNEG est égale à VERASE).

- 5 Il apparaîtra clairement à l'homme de l'art que le décodeur de ligne de mot qui vient d'être décrit est susceptible de diverses variantes de réalisation, notamment en ce qui concerne la réalisation des pilotes de ligne de mot, des décodeurs de groupe et des décodeurs
- 10 de sous-groupe, tout en restant dans le cadre de la présente invention.

Tableau 2

Modes	Sceaux de Contrôle		Tensions		Etat	Prédecodage				Postdecodage					Multiplexage	
	SES	MDS (BIE2)	INSEL	INSEL		IXI	IXI	PSJ	PDJ	GRJ	SPJ	SPNJ	DECJ	DECNJ	VIJ	Fig. 5A-5L
READ	0	00	0	VNEG	VPOS	SEL	1	1	0	0	4.5	0	0	4.5	4.5	5A
				VNEG=VREAD	VPOS=VREAD		1	1	0	0	0	4.5	0	4.5	0	5B
				VNEG=VREAD	VREAD=4.5 V		0	0	1	0	4.5	0	0	4.5	0	5C
				VNEG=VREAD	VREAD=4.5 V		0	0	0	0	4.5	0	0	4.5	0	5D
PROG	0	10	0	VNEG=VPINHIB	VPOS=VPP	SEL	1	1	1	-1.5	7.5	-1.5	-1.5	7.5	7.5	5E
				VNEG=VPINHIB	VPP=7.5V		1	1	0	-1.5	0	7.5	-1.5	7.5	-1.5	5F
				VNEG=VPINHIB	VPP=7.5V		0	0	1	7.5	7.5	-1.5	-1.5	7.5	-1.5	5G
				VNEG=VPINHIB	VPP=7.5V		0	0	0	7.5	0	7.5	-1.5	7.5	-1.5	5H
PERASE	0	11	1	VNEG=VER	VPOS=VEINHIB	SEL	1	1	1	0	0	-9	-9	0	-9	5I
				VNEG=VER	VEINHIB=0V		1	1	0	0	0	-9	0	-9	0	5J
				VNEG=VER	VEINHIB=0V		0	0	1	-9	0	-9	0	-9	0	5K
				VNEG=VER	VEINHIB=0V		0	0	1	-9	0	-9	-9	0	0	5L
SERASE	1	11	0	idem	idem	SEL	0	0	1	0	0	0	-9	0	-9	

Tableau 3 (élément de décodage de groupe GPGENi)

Lx (a) ET Ly (b)	INVSEL	GPATVPOS	GPATVNEG
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

5

Tableau 4 (élément de décodage de groupe GPGENi)

INVSEL	GPATVPOS IN1 (ELVCT)	GPATVNEG IN (NEGSW) IN2 (ELVCT)	OUTN (ELVCT)	OUT (NEGSW)	OUTHN (NEGSW)	GPI
0	0	1	1 (VPOS)	1 (Vcc)	0 (VNEG)	VNEG
0	1	0	0 (0V)	0 (VNEG)	1 (Vcc)	VPOS
1	0	1	1 (VPOS)	1 (-Vtn)	0 (VNEG)	VNEG
1 (Vcc)	1	0	0 (0V)	0 (VNEG)	1 (Vcc)	0

10 Tableau 5 (élément de décodage de sous-groupe DECGENj)

PDj IN (NEGSW)	OUTH (NEGSW)	OUTN (NEGSW)	DECj	DECNj
0 (0V)	0 (VNEG)	1 (-Vtn)	VNEG	VPOS
1 (Vcc)	1 (Vcc)	0 (VNEG)	0V	X (*)
(*) X=VPOS si VNEG=0 (mode READ) X=VNEG si VPOS=0 (mode PERASE) .				



Tableau 6 (élément de décodage de sous-groupe SPGENj)

VNEG	PSj	IN (NEGSW)	OUT (NEGSW)	SPj	SPNj
VNREAD (0V) ou VPINHIB (-1,5V)	0 (0V)	0 (0V)	VNEG	0 (0V)	1 (VPOS)
VNREAD (0V) ou VPINHIB (-1,5V)	1 (Vcc)	1 (Vcc)	Vcc	1 (VPOS)	0 (VNEG)
VER (-9V)	0 (0V)	0 (0V)	VNEG	0V	0V
VER (-9V)	1 (Vcc)	1 (Vcc)	-Vtn	0V	0V

5 Tableau 7 (circuit élévateur de tension ELVCT)

IN1 (ELVCT)	IN2 (ELVCT)	OUTN (ELVCT)
0 (0V)	1 (Vcc)	1 (VPOS)
1 (Vcc)	0 (0V)	0 (0V)

Tableau 8 (commutateur de tension négative NEGSW)

Modes	IN (NEGSW)	OUT (NEGSW)	OUTN (NEGSW)	OUTH (NEGSW)	OUTHN (NEGSW)
ERASE /	1 (Vcc)	1 (-Vtn)	0 (VNEG)	1 (Vcc)	0 (VNEG)
SERASE (*)	0 (0V)	0 (VNEG)	1 (-Vtn)	0 (VNEG)	1 (Vcc)
READ /	1 (Vcc)	1 (Vcc)	0 (VNEG)	1 (Vcc)	0 (VNEG)
PROG (**)	0 (0V)	0 (VNEG)	1 (Vcc)	0 (VNEG)	1 (Vcc)

10 (*) VCASC = 0

(**) VCASC = VPOS

REVENDEICATIONS

1. Décodeur d'adresse (WLDEC2) pour appliquer sélectivement à des lignes de mot (WLi,j) d'un plan mémoire (MA) des signaux (Vi,j) de polarité variable, négative ou positive, dont la valeur est fonction d'une
5 adresse (ADR) de ligne de mot appliquée au décodeur, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un décodeur de groupe (GPGEN) délivrant des signaux (GPi) de sélection de groupe de lignes de mot qui sont de polarité variable (VPOS, VNEG),
- 10 - au moins un décodeur de sous-groupe (DECGEN, SPGEN) délivrant des signaux (SPj , $SPNj$, $DECj$, $DECNj$) de sélection de sous-groupe de lignes de mot qui sont également de polarité variable, un sous-groupe de lignes de mot comprenant un ensemble de lignes de mot
15 appartenant à des groupes de lignes de mot différents, et
- des pilotes de ligne de mot (Di,j) à raison d'un pilote de ligne de mot (Di,j) par ligne de mot (WLi,j), comprenant chacun des moyens (TP1, TP2, TN1, TN2) de multiplexage des signaux de sélection de groupe et de
20 sous-groupe, pour sélectionner et appliquer sélectivement, un de ces signaux à une ligne de mot.

2. Décodeur selon la revendication 1, dans lequel :

- un groupe de lignes de mot ($GRPi$) comprend un ensemble
25 de lignes de mot ayant des bits d'adresse (A3-A7) de poids déterminé identiques, et
- un sous-groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de mot ayant des bits d'adresse (A8-A10) de poids déterminé identiques, tout en appartenant à des groupes
30 de lignes de mot différents.

3. Décodeur selon la revendication 2, dans lequel un groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes

de mot ayant des bits d'adresse de poids fort (A3-A7) identiques, et un sous-groupe de lignes de mot comprend un ensemble de lignes de mot ayant des bits d'adresse de poids faible (A8-A10) identiques.

5

4. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel un pilote de ligne de mot comprend des transistors interrupteurs de type MOS (TP1, TP2, TN1, TN2) qui sont à la fois pilotés sur leur grille et polarisés sur leur drain et leur source par les signaux de sélection de groupe et de sous-groupe (SPj, SPNj, DECj, DECNj), et sont agencés pour sélectionner un de ces signaux et l'appliquer à une ligne de mot.

15 5. Décodeur selon la revendication 4, dans lequel un pilote de ligne de mot comprend des transistors interrupteurs (TP1, TP2, TN1, TN2) ayant chacun :

- une borne reliée à une ligne de mot,
- une borne recevant un signal de sélection de groupe ou de sous-groupe (GPI, SPj, DECj), et
- 20 - une grille recevant un signal de sélection de groupe ou de sous-groupe (GPI, SPj, DECj).

25 6. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le décodeur de sous-groupe comprend :

- un premier décodeur de sous-groupe (DECGEN), délivrant des premiers signaux (DECj, DECNj) de sélection de sous-groupe dont la valeur est fonction de l'adresse de ligne de mot appliquée au décodeur pendant des phases (PERASE, SERASE) d'effacement de cellules mémoire, et est
- 30 indépendante de l'adresse appliquée au décodeur pendant des phases (READ, PROGVER) de lecture ou de programmation de cellules mémoire, et

- un second décodeur de sous-groupe (SPGEN)
- 35 délivrant des seconds signaux (SPj, SPNj) de sélection de

sous-groupe dont la valeur est fonction de l'adresse de ligne de mot appliquée au décodeur pendant les phases de lecture ou de programmation (READ, PROGVER), et est indépendante de l'adresse appliquée au décodeur pendant
5 les phases d'effacement (PERASE, SERASE).

7. Décodeur selon la revendication 6, dans lequel chacun des décodeurs de sous-groupe reçoit une première (VNEG) et une seconde (VPOS) tension de référence et
10 fournit, en sus d'un signal de sélection de sous-groupe (DECj, SPj), un signal complémentaire de sélection de sous-groupe (DECNj, SPNj) égal à la seconde tension de référence (VPOS) quand le signal de sélection de sous-groupe est égal à la première tension de référence (VNEG)
15 et égal à la première tension de référence (VNEG) quand le signal de sélection de sous-groupe est égal à la seconde tension de référence (VPOS).

8. Décodeur selon la revendication 7, dans lequel
20 un pilote de ligne de mot comprend :
- des transistors MOS (TP2, TN2) dont les grilles sont pilotées par l'un des signaux complémentaires (DECNj, SPNj), et
- des transistors MOS (TP1, TN1) dont les grilles sont
25 pilotées par des signaux (GPI) de sélection de groupe.

9. Décodeur selon l'une des revendications 7 et 8, dans lequel un pilote de ligne de mot comprend :
- un premier transistor MOS (TP1) ayant une borne de drain ou de source reliée à une ligne de mot (WLi,j),
30 recevant sur sa grille un signal de sélection de groupe (GPI) et recevant sur une borne de source ou de drain un premier signal de sélection de sous-groupe (SPj),
- un deuxième transistor MOS (TN1) ayant une borne de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant sur
35

sa grille le signal de sélection de groupe (GPI) et recevant sur une borne de source ou de drain un second signal de sélection de sous-groupe (DECj),

- un troisième transistor MOS (TP2) ayant une borne de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant sur sa grille un premier signal complémentaire de sélection de sous-groupe (DECNj) et recevant sur une borne de source ou de drain un second signal de sélection de sous-groupe (SPj), et

- un quatrième transistor MOS (TN2) ayant une borne de drain ou de source reliée à la ligne de mot, recevant sur sa grille un second signal complémentaire de sélection de sous-groupe (SPNj) et recevant sur une borne de source ou de drain un premier signal de sélection de sous-groupe (DECj).

10. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence (VNEG, VPOS) qui sont respectivement égales à une tension de non-lecture (VNREAD) et à une tension de lecture (VREAD) pendant la lecture de cellules mémoire.

11. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence (VNEG, VPOS) qui sont respectivement égales à une tension d'inhibition de programmation (VPINHIB) et à une tension de programmation (VPP) pendant la programmation de cellules mémoire.

12. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel les décodeurs de groupe et de sous-groupe reçoivent deux tensions de référence (VNEG, VPOS) qui sont respectivement égales à une tension d'effacement

(VER) et à une tension d'inhibition d'effacement (VEINHIB) pendant l'effacement de cellules mémoire.

13. Décodeur selon les revendications 10, 11 et 12, dans lequel la tension de programmation est positive, la tension d'inhibition de programmation et la tension d'effacement sont négatives, les tensions de non lecture et d'inhibition d'effacement sont nulles.

14. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 13, comprenant un étage de prédécodage (PREDEC1) fournissant des signaux de prédécodage (Lx(a), Ly(b), LBS) aux décodeurs de groupe et de sous-groupe.

15. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel le décodeur de groupe et le décodeur de sous-groupe fournissent des signaux de sélection positifs, négatifs ou nuls.

16. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 15, dans lequel le décodeur de groupe (GPGEN) comprend des circuits élévateurs de tension (ELVCT) pour transformer un signal logique égal à 1 ayant un niveau de tension positif déterminé (Vcc) en un signal logique ayant un niveau de tension positif de valeur supérieure, égal à une tension de référence (VNEG) fournie aux circuits élévateurs de tension.

17. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 16, dans lequel les décodeurs de groupe et de sous-groupe comprennent des commutateurs de tension (NEGSW, OUT) pour transformer des signaux logiques à 0 et à 1 en des signaux ayant des niveaux de tension négatifs différents (VPOS, -Vt).

18. Décodeur selon l'une des revendications 1 à 17,
dans lequel les décodeurs de groupe et de sous-groupe
comprennent des commutateurs de tension (NEGSW, OUTH)
agencés pour transformer un signal logique à 0 en un
5 signal de tension négative (VNEG) et signal logique à 1
en un signal de tension positive (Vcc).

1/8

100212FR

DESSINS PROVISOIRES

Dessins Définitifs en cours d'élaboration

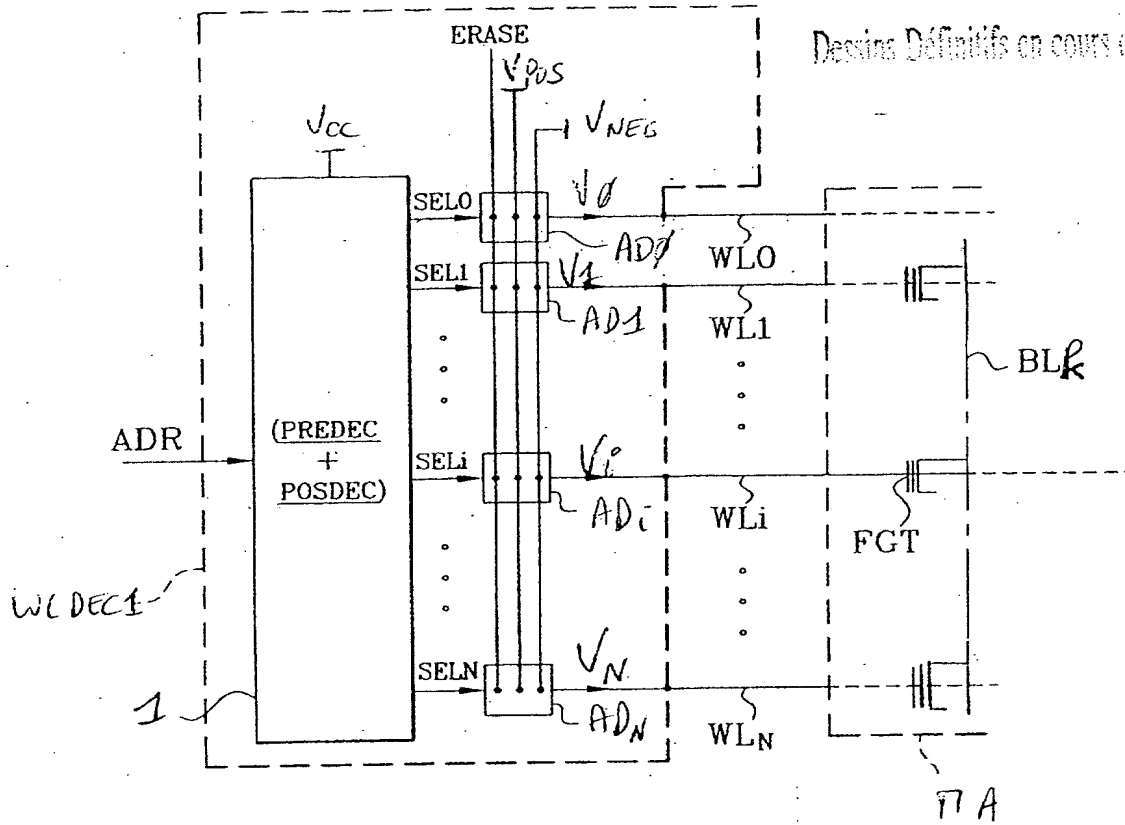


FIG. 1

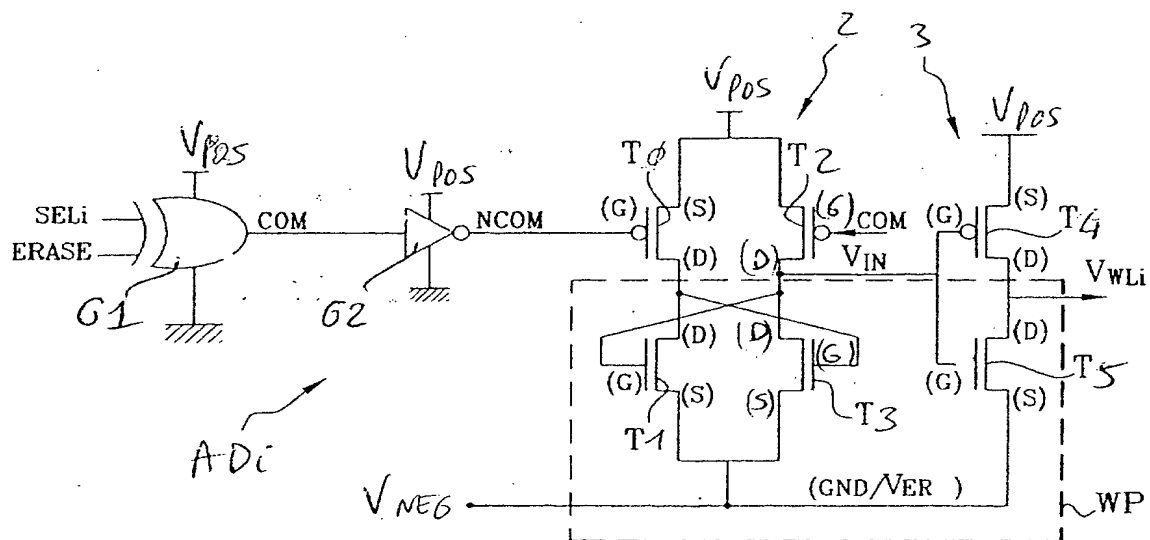


FIG. 2

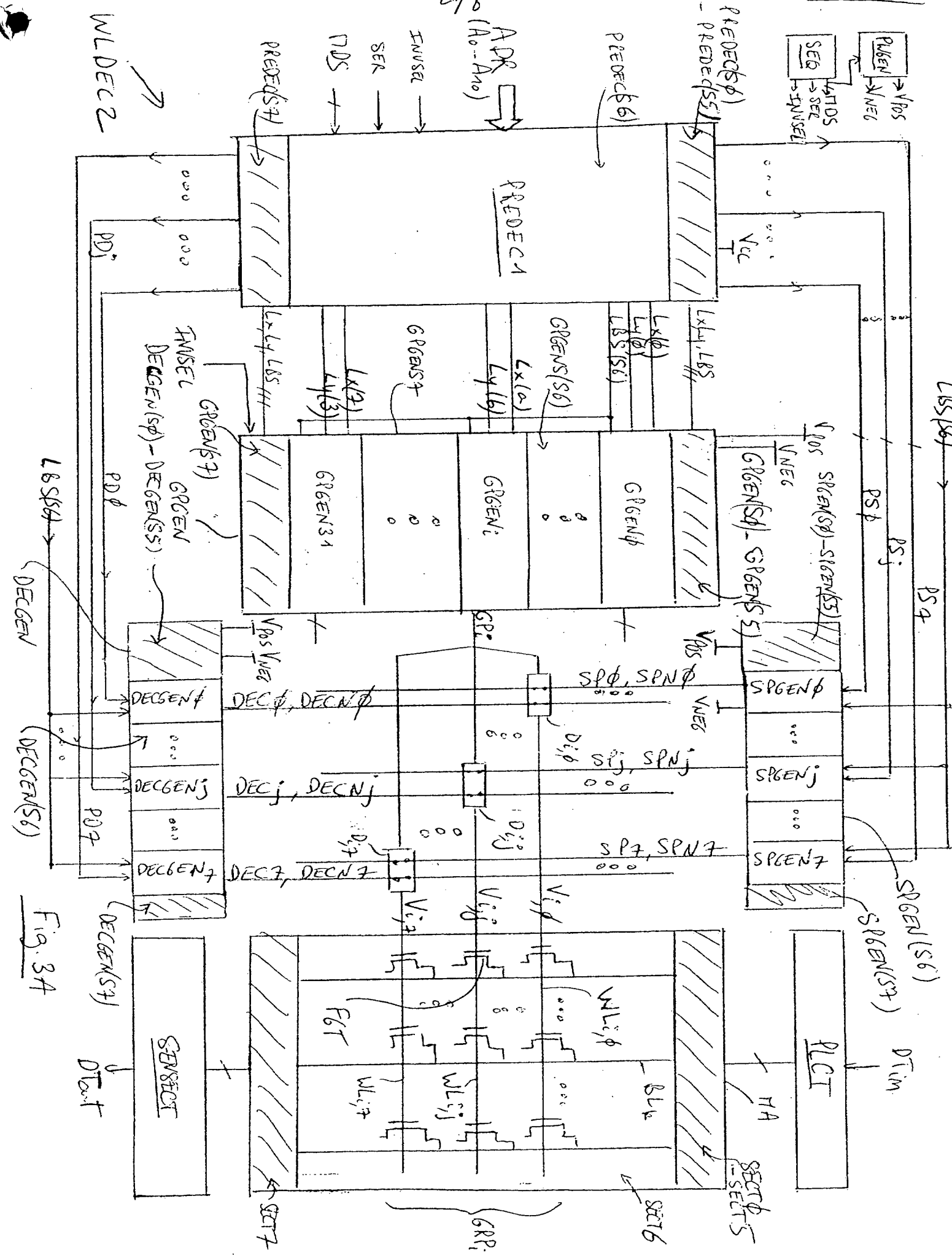


Fig. 34

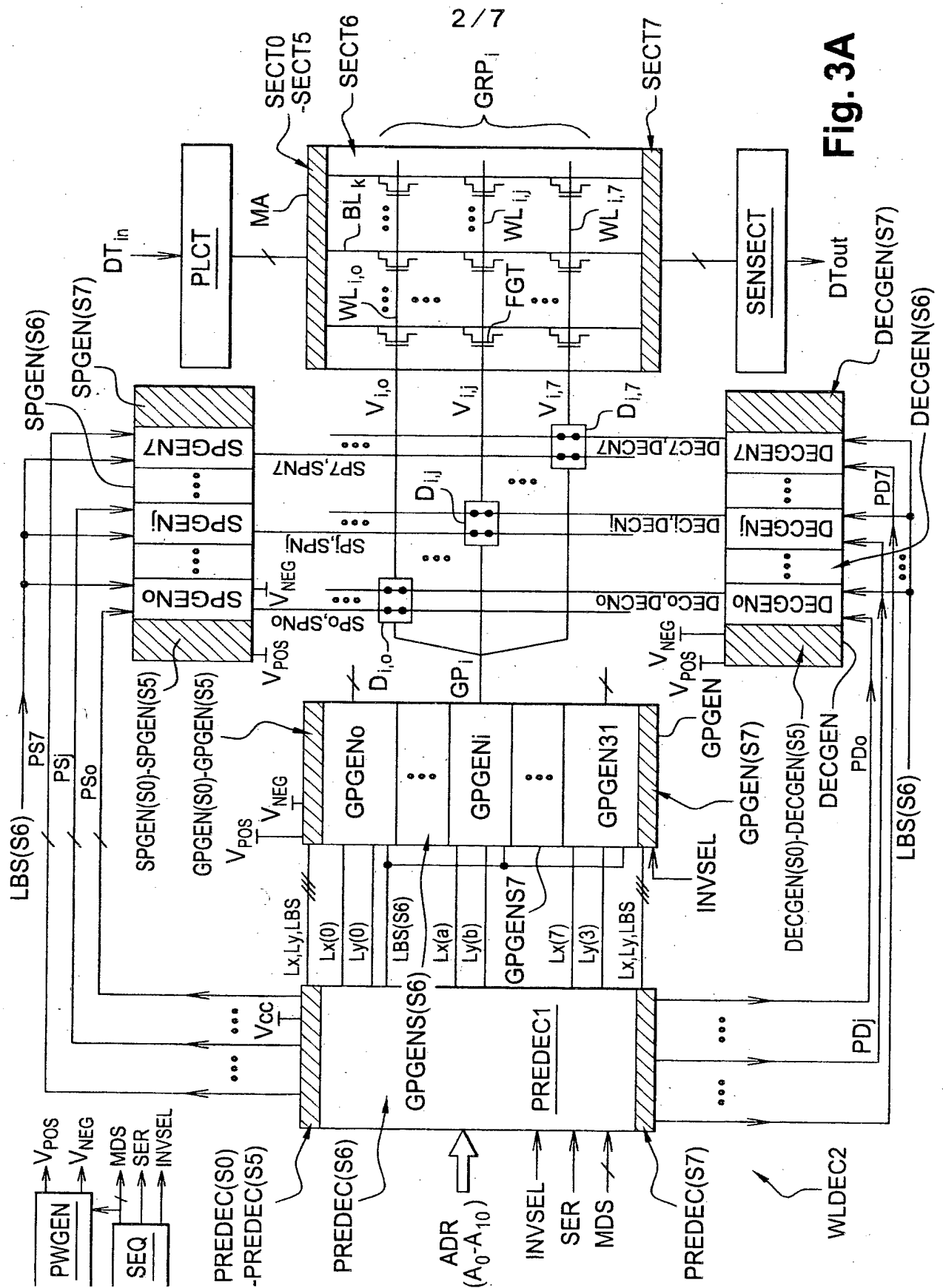
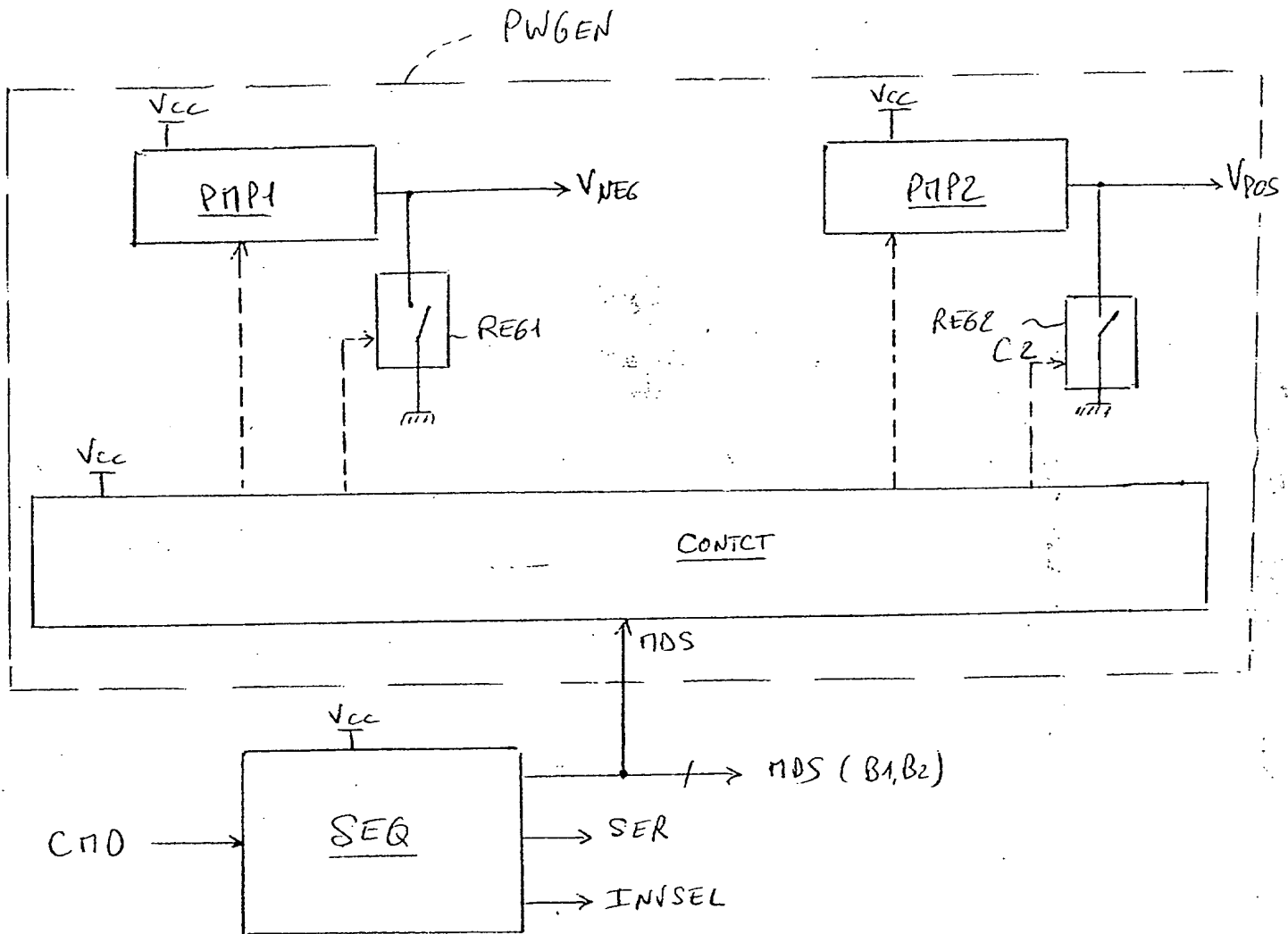


Fig. 3A

3/8

Fig. 3B

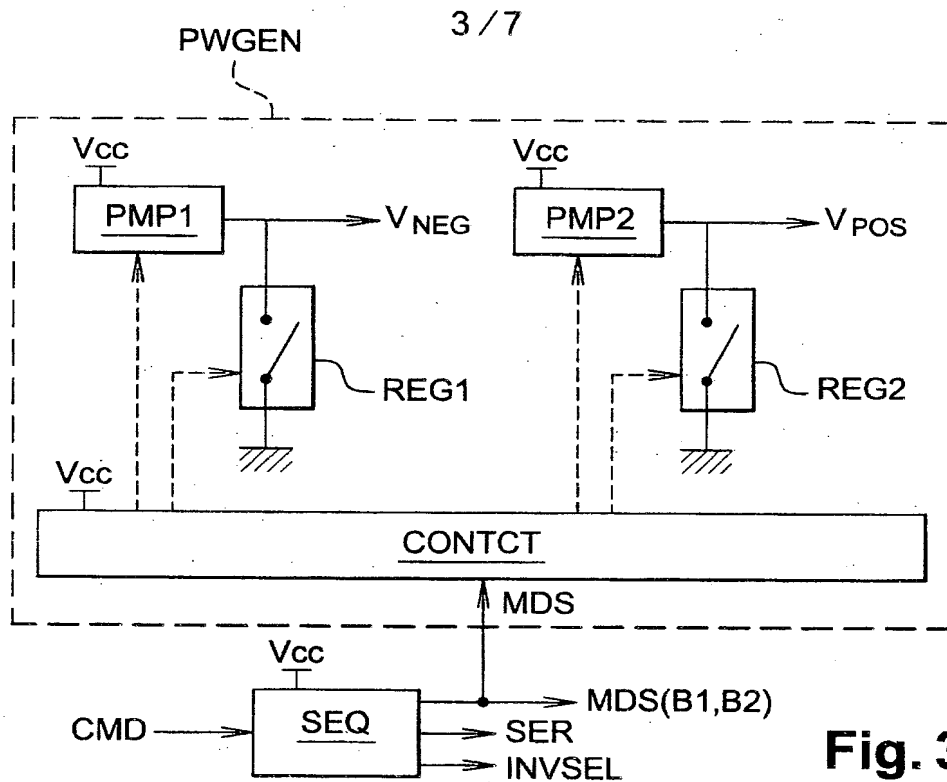


Fig. 3B

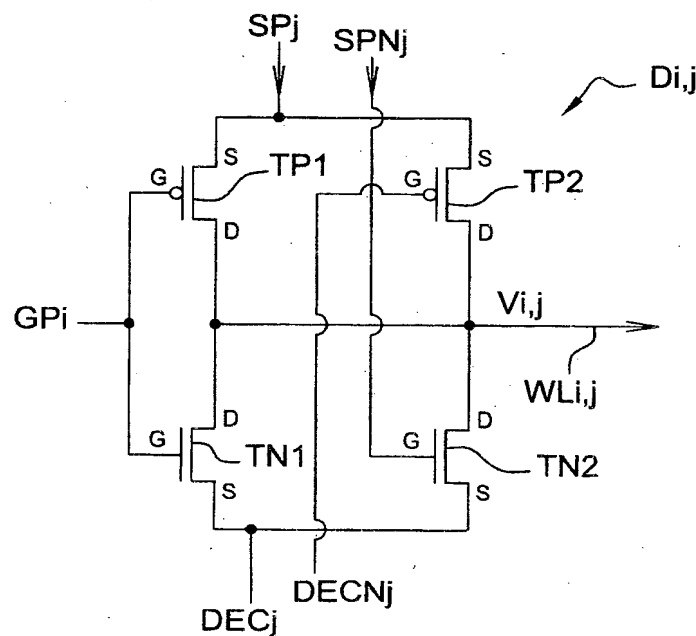
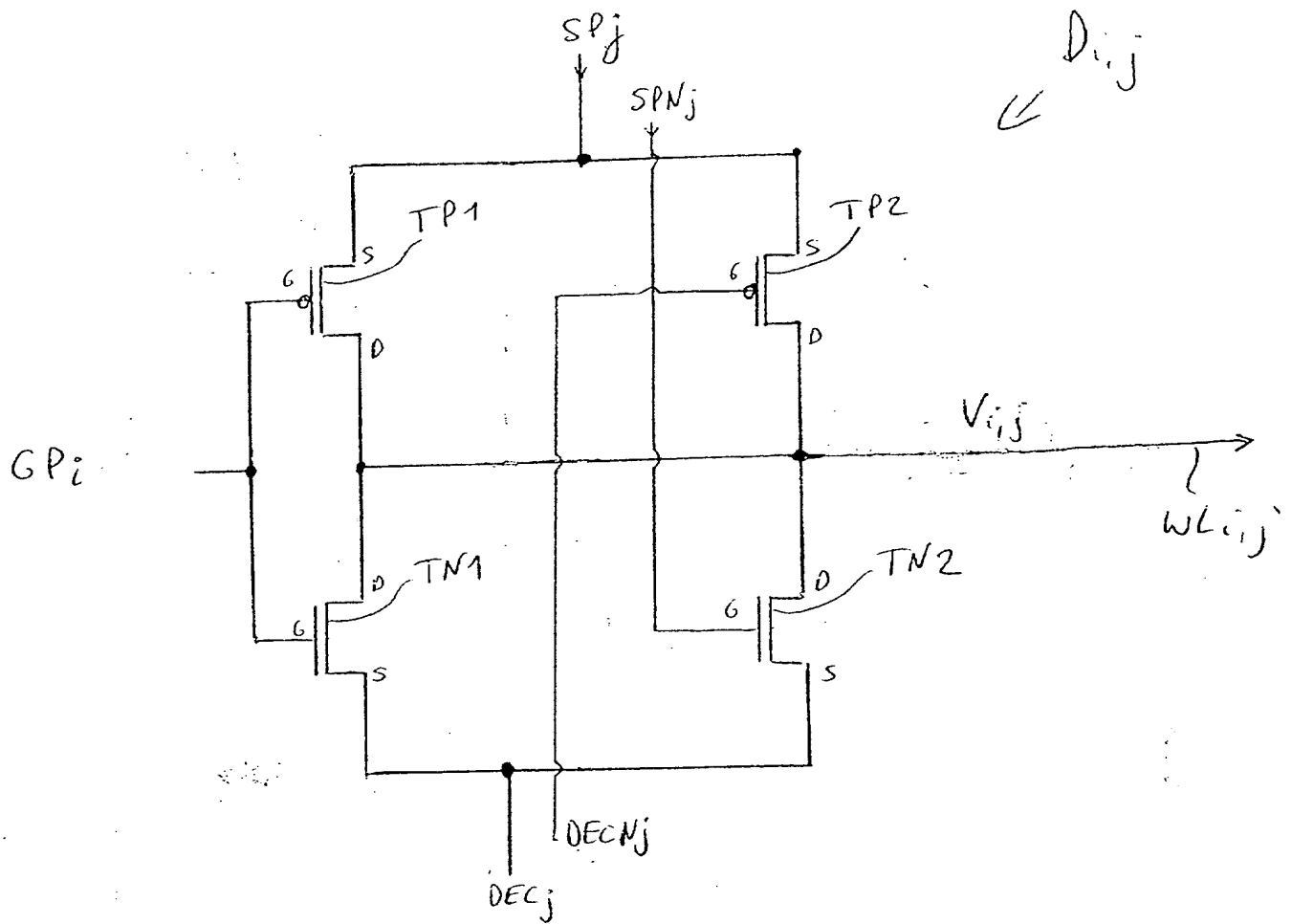
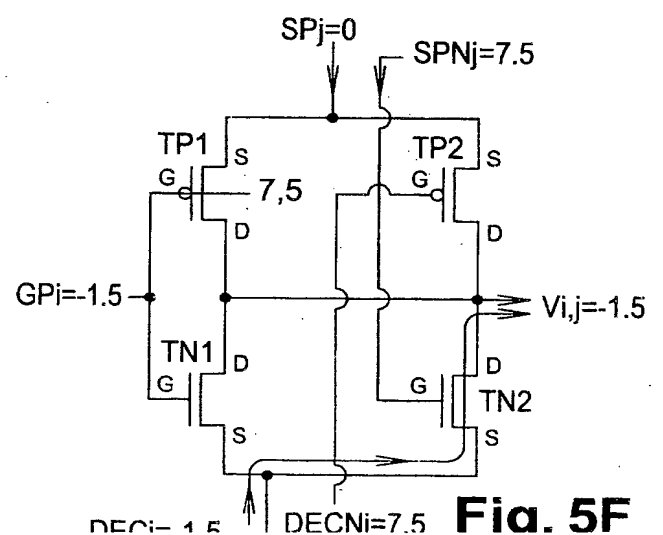
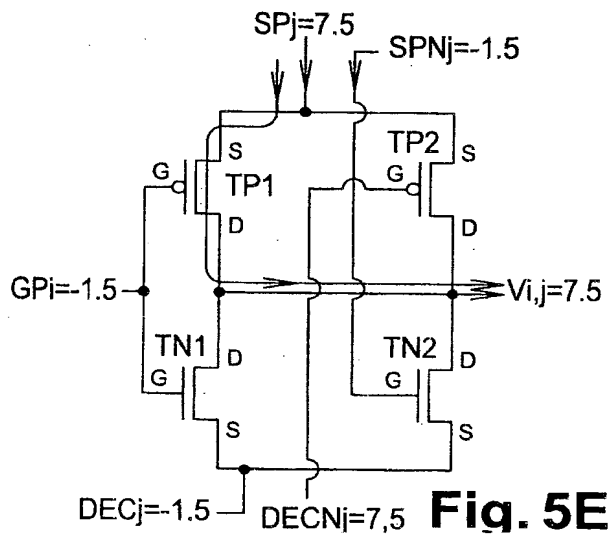
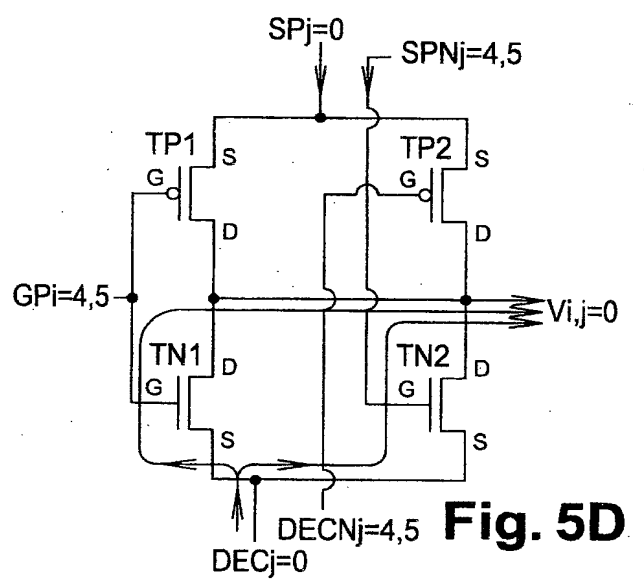
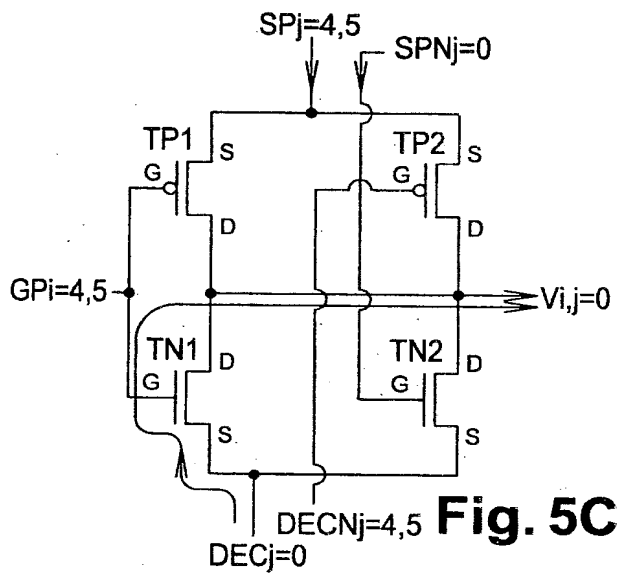
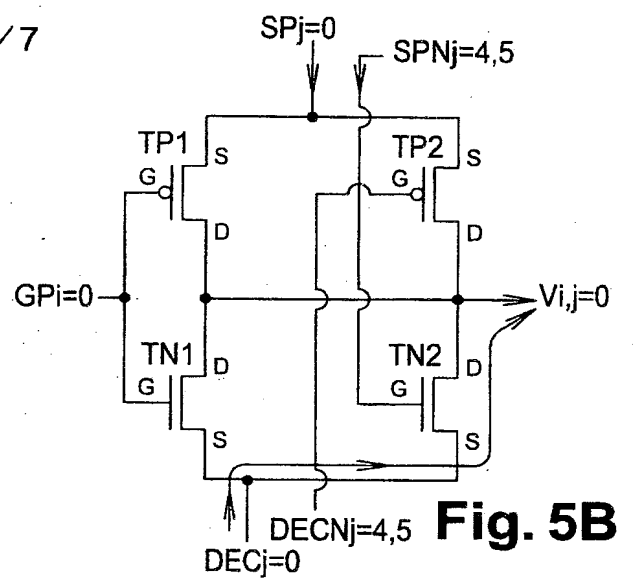
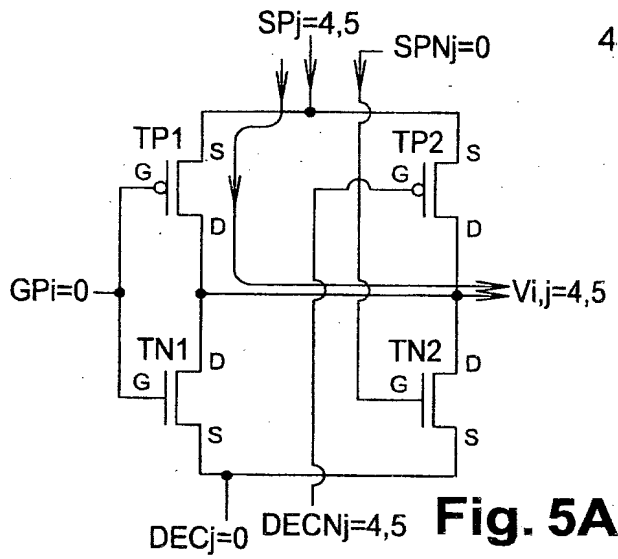


Fig. 4

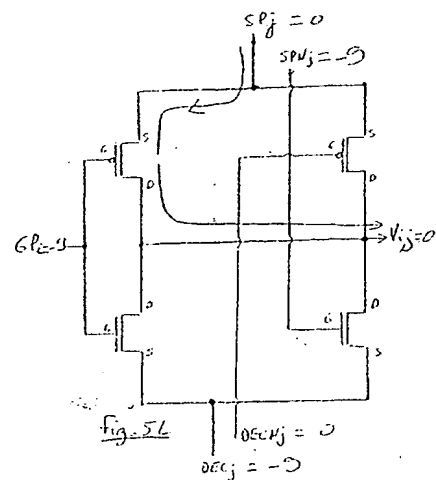
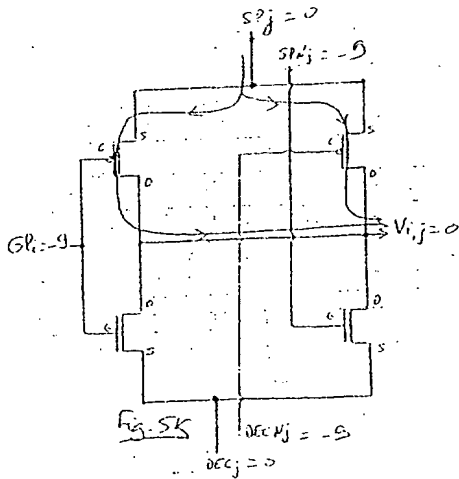
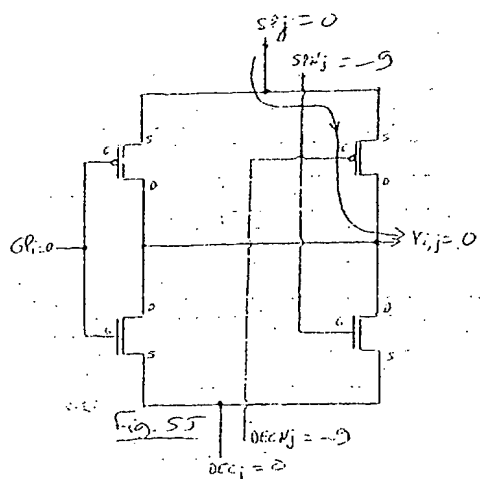
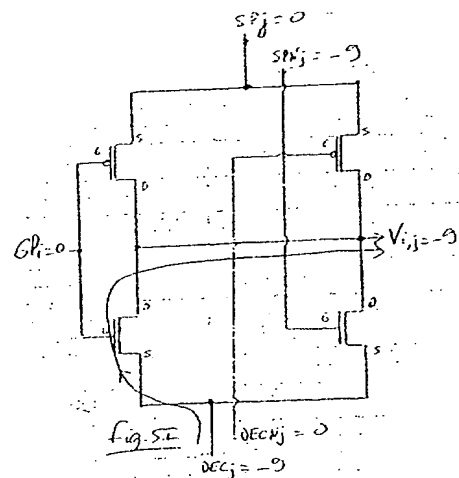
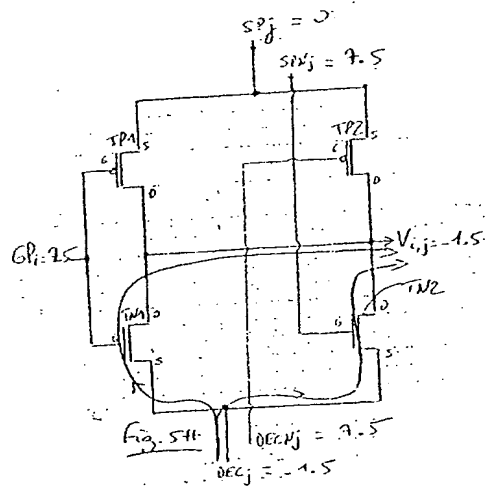
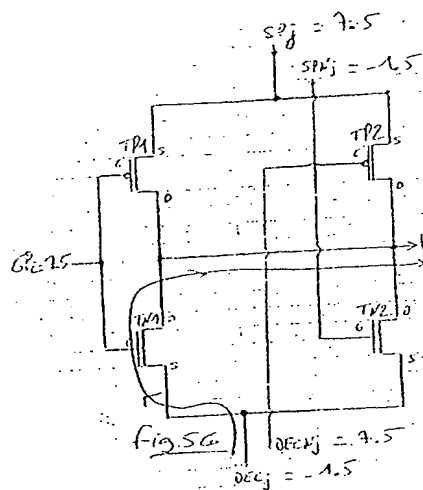
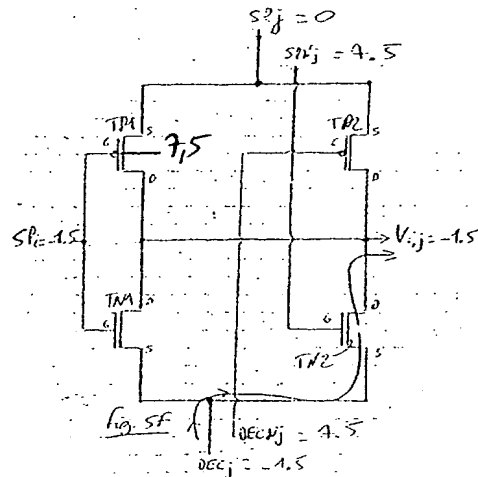
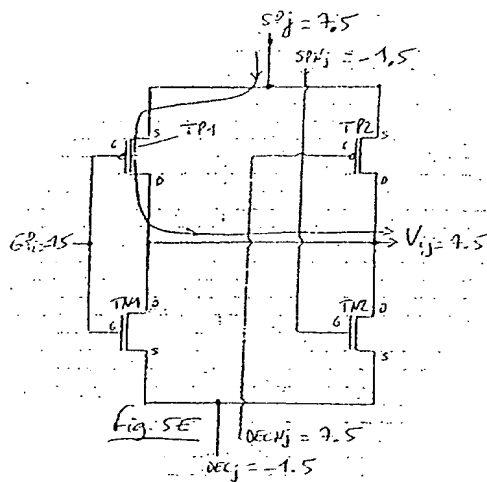
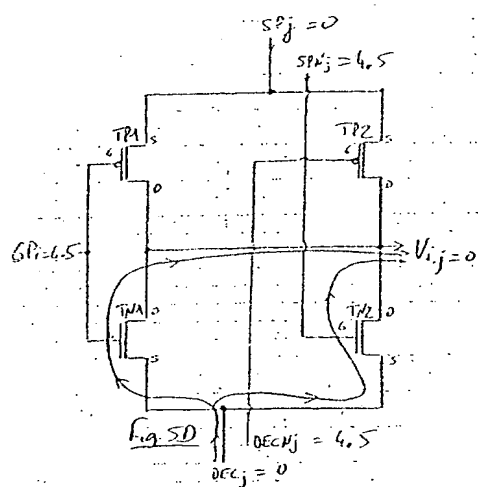
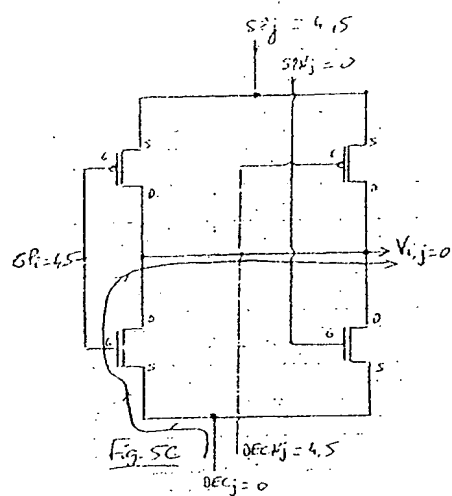
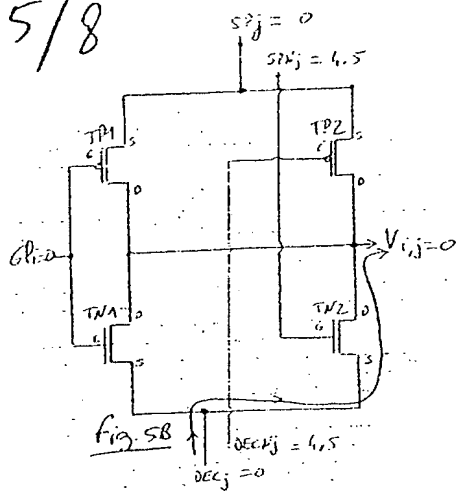
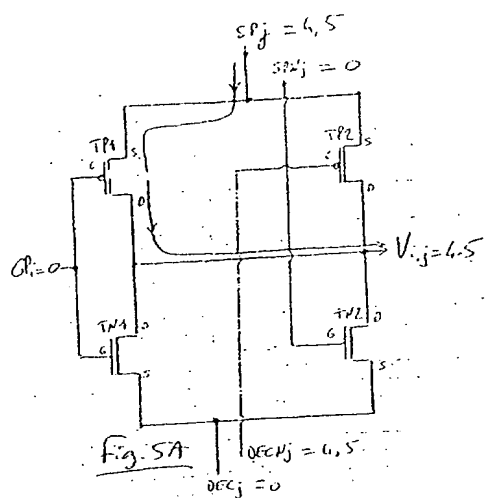
Fig. 4



4 / 7

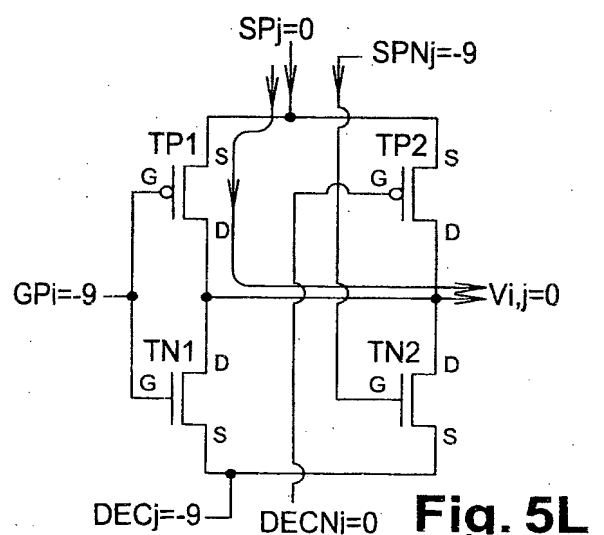
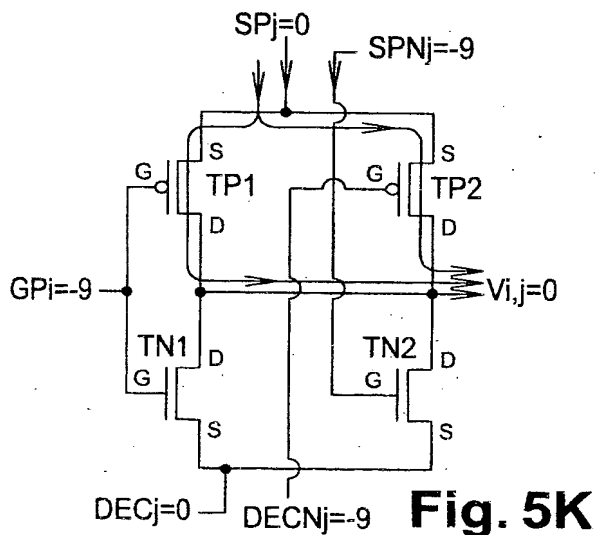
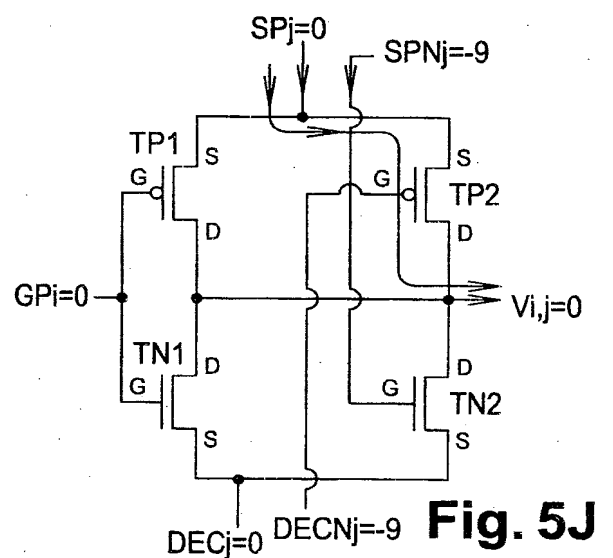
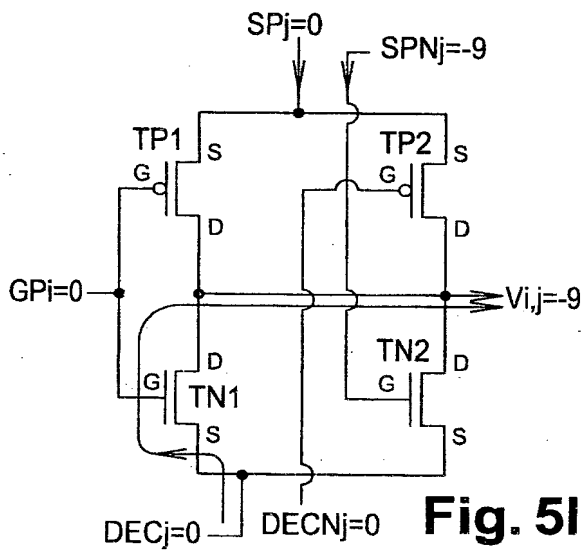
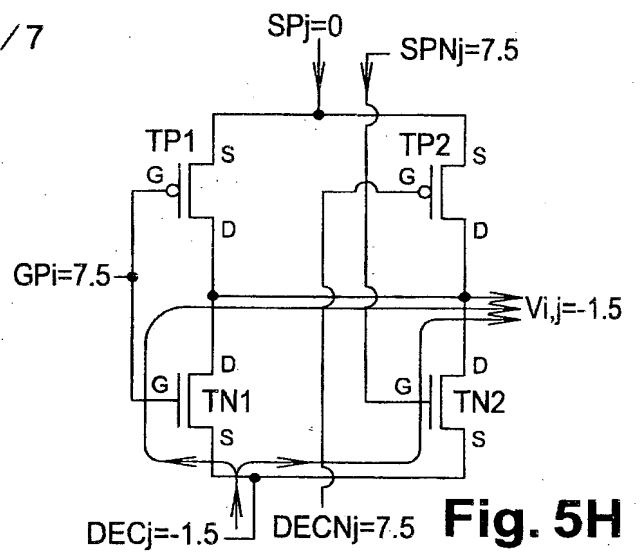
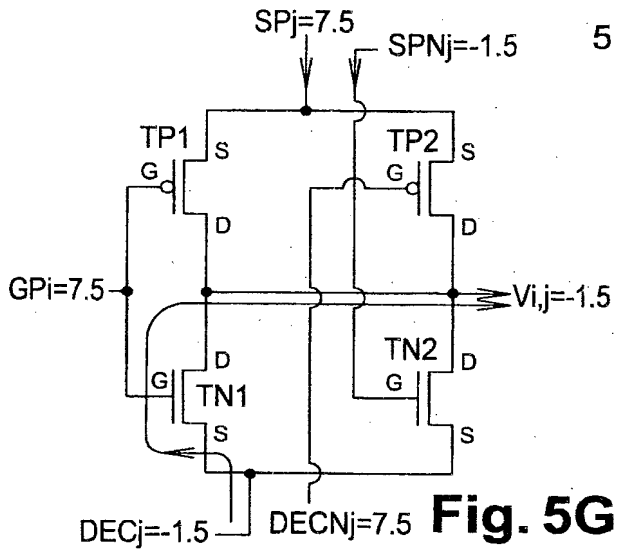


5/8





5 / 7



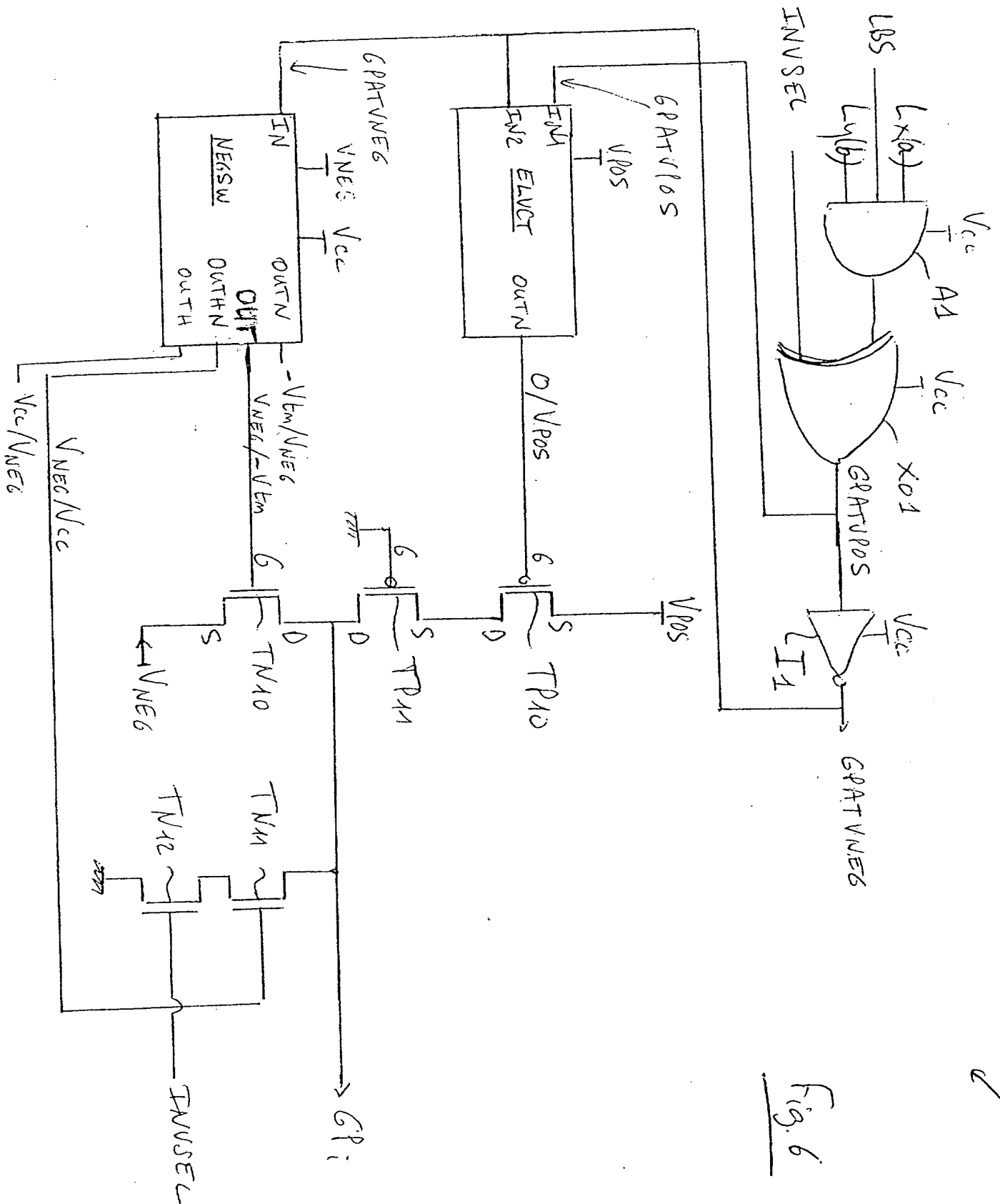
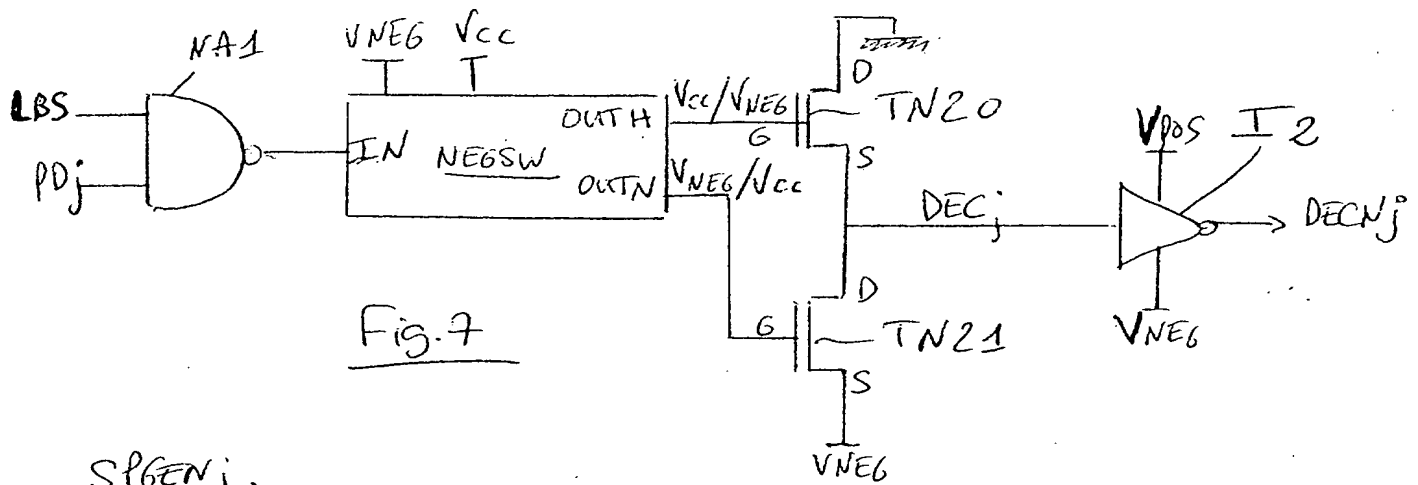
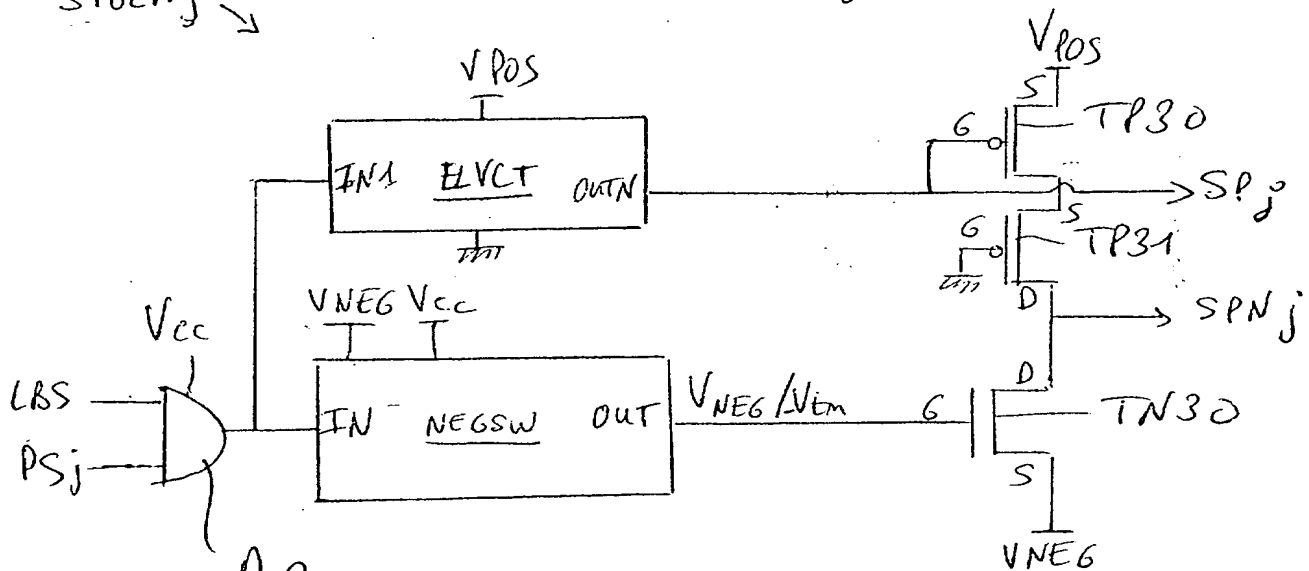
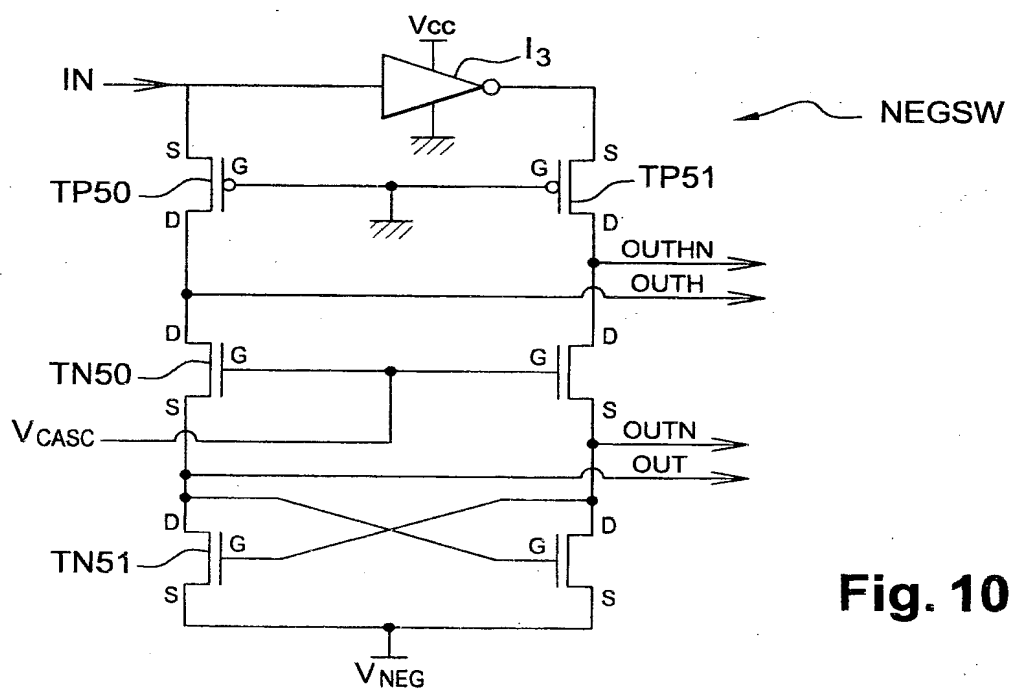
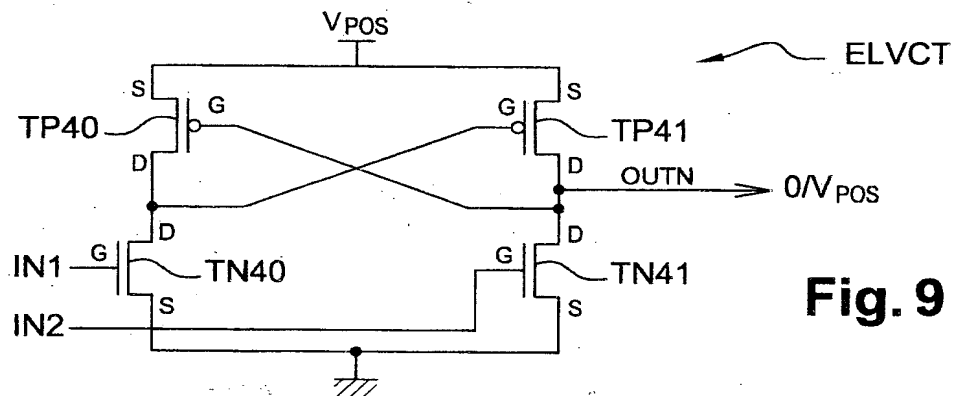
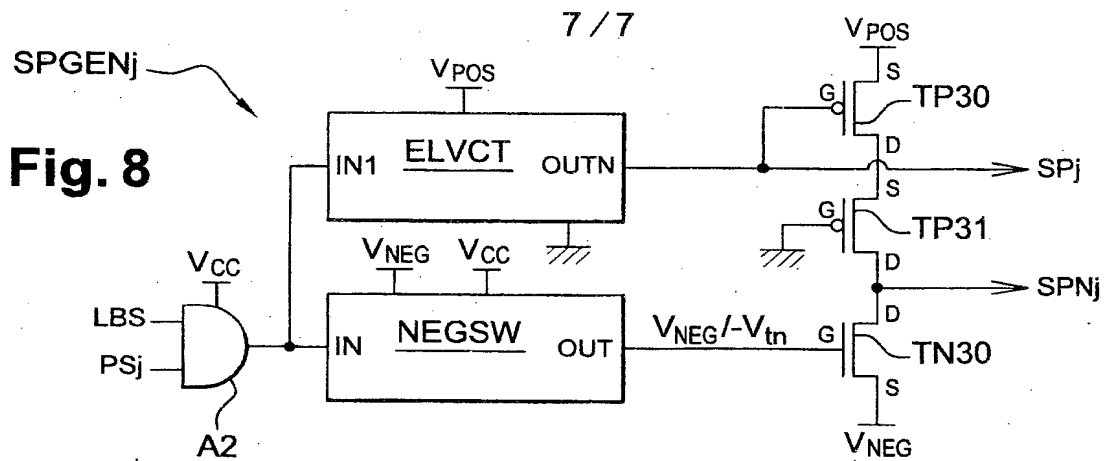


Fig. 6

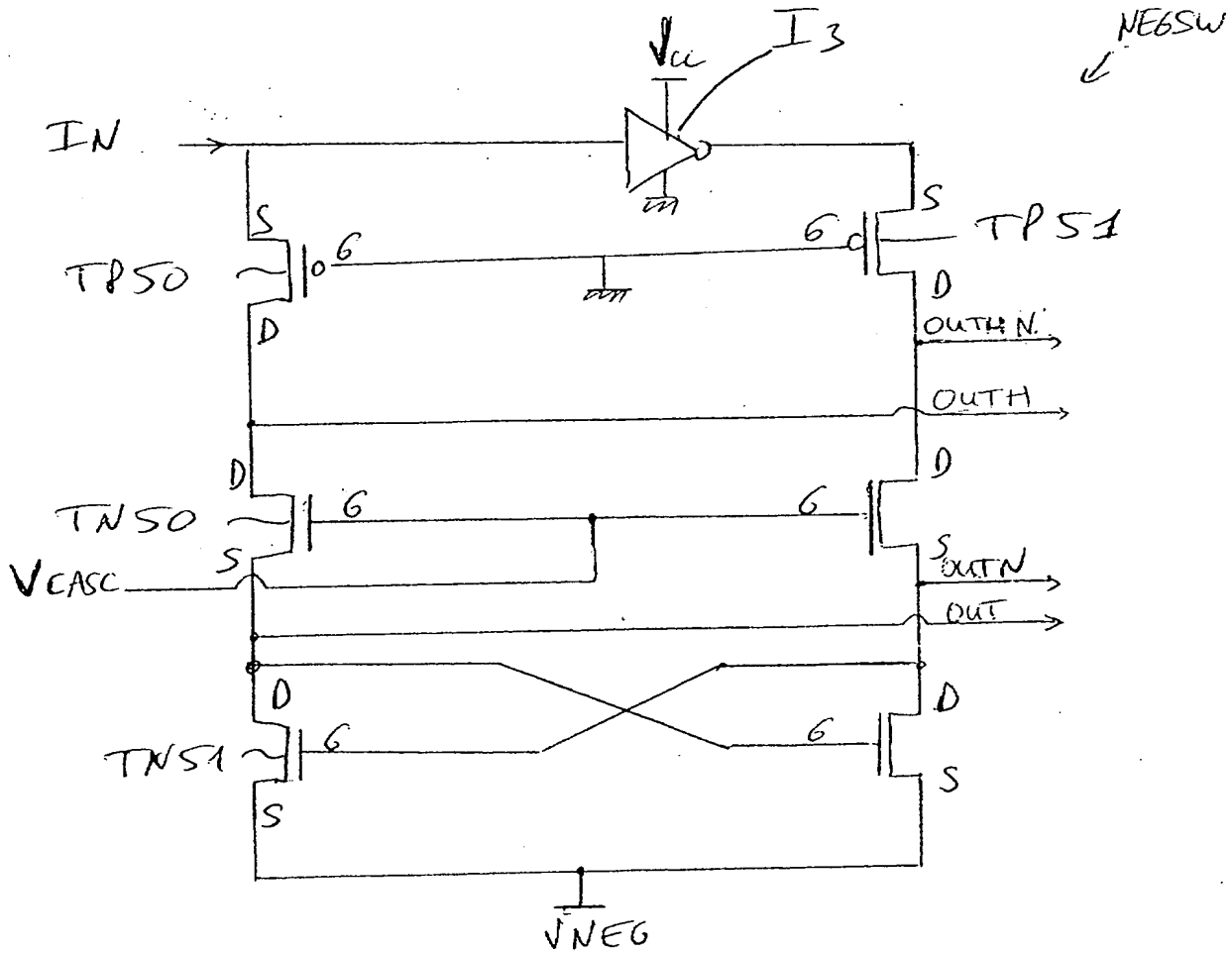
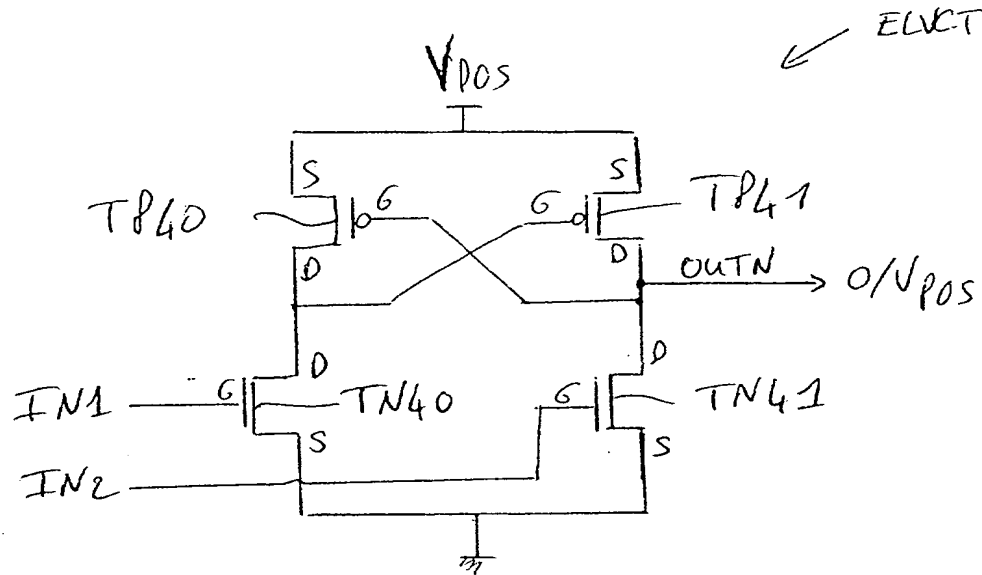
GPATVNEG

7/8

DEC GEN_j →Fig. 7SP GEN_j →Fig. 8



8/8

100212 FR



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

21 JAN 2003		100212 FR	
Vos références (facultatif)		100212 FR	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0300615	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Décodeur de ligne de mot à tension négative, ayant des éléments de terminaison de faible encombrement			
LE(S) DEMANDEUR(S) : MARCHAND André OMNIPAT 24, Place des Martyrs de la Résistance 13100 AIX EN PROVENCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		LECONTE	
Prénoms		Bruno	
Adresse	Rue	C/O OMNIPAT 24 Place des Martyrs de la Résistance	
	Code postal et ville	13100	AIX EN PROVENCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		CAVALERI	
Prénoms		Paola	
Adresse	Rue	C/O OMNIPAT 24 Place des Martyrs de la Résistance	
	Code postal et ville	13100	AIX EN PROVENCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		ZINK	
Prénoms		Sébastien	
Adresse	Rue	C/O OMNIPAT 24 Place des Martyrs de la Résistance	
	Code postal et ville	13100	AIX EN PROVENCE
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Aix en Provence, le 20 janvier 2003 MARCHAND André - CPI N° 95 0303 OMNIPAT			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.